

ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
БІБЛІОТЕКА

Серія «Біобібліографія вчених ВНУ ім. Лесі Українки»

ФЕДОСОВ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Біобібліографічний покажчик

Луцьк–2021

Федосов Сергій Анатолійович : біобібліогр. покажч. до 50-річчя від дня народж. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук ; упоряд. С. А. Федосов. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. – 65 с. – (Серія «Біобібліографія вчених ВНУ ім. Лесі Українки»).

У біобібліографічному покажчику висвітлено життєвий і творчий шлях відомого українського науковця, доктора фізико-математичних наук, професора кафедри теоретичної та комп'ютерної фізики імені А. В. Свідзинського Волинського національного університету імені Лесі Українки – Сергія Анатолійовича Федосова.

Уміщено бібліографію праць науковця, що охоплюють період від 1993 до 2020 рр., а також біографічну довідку.

Бібліографічний опис видань оформлено згідно з чинними стандартами.

Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів.

ЗМІСТ

ВІД УПОРЯДНИКА	4
I. БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА.....	6
II. ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ПРОФЕСОРА С. А. ФЕДОСОВА.....	10
Дисертації та автореферати дисертацій.....	10
Навчально-методичні видання, практикуми, задачі	11
Статті у продовжуваних, періодичних та неперіодичних виданнях	18
Доповіді на наукових конференціях та семінарах.....	32
Депонована праця	52
III. ПЕРЕЛІК АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ ЗАХИЩЕНИХ ПІД НАУКОВИМ КЕРІВНИЦТВОМ С. А. ФЕДОСОВА.....	53
IV. ПЕРЕЛІК АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ, ПРИ ЗАХИСТІ ЯКИХ С. А. ФЕДОСОВ ВИСТУПАВ ОФІЦІЙНИМ ОПОНЕНТОМ.....	53
АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК НАЗВ ПРАЦЬ	54
ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК СПІВАВТОРІВ	63

ВІД УПОРЯДНИКА

Біобібліографічний покажчик присвячено науковій діяльності доктора фізико-математичних наук, професора кафедри теоретичної та комп'ютерної фізики імені А. В. Свідзинського Волинського національного університету імені Лесі Українки – Сергію Анатолійовичу Федосову.

Посібник містить біографічну довідку, хронологічний покажчик наукових праць, перелік дисертацій, захищених під керівництвом науковця, опонування, довідково-допоміжний апарат.

Хронологічний покажчик наукових праць професора С. А. Федосова представлено в другому розділі покажчика. Він включає бібліографічні відомості про автореферати та дисертацій, монографії, навчально-методичні видання, практикуми, задачі, статті у продовжуваних, періодичних та неперіодичних виданнях, доповіді на наукових конференціях та семінарах та інші публікації, які розкривають аспекти діяльності науковця з 1993 до 2020 року. Бібліографія нараховує більше 200 публікацій.

Перелік дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата, захищених під науковим керівництвом С. А. Федосова вміщено в третьому розділі покажчика.

Четвертий розділ містить дисертації з офіційним опонуванням професора.

У межах розділів бібліографічні описи розміщені в хронологічному порядку, у межах року – за абеткою. Співавтори зазначені в області приміток, після бібліографічного опису документа.

Матеріали в покажчику бібліографуються мовою оригіналу. Усі записи мають наскрізну нумерацію, для зручності пошуку використовується система допоміжного довідкового апарату: іменний покажчик співавторів та алфавітний покажчик назв праць науковця.

Матеріали, зібрані в покажчику, переважно звірені *de visu*.

Бібліографічний опис видань та скорочення термінів у покажчику подаються відповідно до ДСТУ ГОСТу 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою».

Загальні вимоги та правила», ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила» та ГОСТ 7.11-78 «Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом описании».

При відборі матеріалу до покажчика використано довідковий апарат бібліотеки ВНУ ім. Лесі Українки, електронні фонди Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського та інших провідних бібліотек України.

I. БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

Сергій Анатолійович Федосов народився 2 травня 1971 р. у м. Луцьк, Волинська область, УРСР. Закінчив в 1988 р. середню школу № 11 м. Луцька. У 1993 р. закінчив Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки за спеціальністю «Фізика і математика».

Працював з вересня 1993 до жовтня 1995 р. на посаді інженера II-ої категорії науково-дослідної лабораторії № 6 «Фізики напівпровідників» кафедри фізики твердого тіла, займався дослідженням фізичних властивостей напівпровідникових матеріалів. З 1995 по 1998 р. навчався в аспірантурі при кафедрі фізики твердого тіла Волинського державного університету імені Лесі Українки.

В 1999 р. захистив дисертацію у Волинському державному університеті імені Лесі Українки й одержав науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук в області фізики напівпровідників і діелектриків.

З 1998 працював старшим викладачем кафедри прикладної математики, з липня 2001 р. – кафедри фізики твердого тіла, а з червня 2002 р. працював на посаді доцента однойменної кафедри, де займався дослідженнями кінетичних і п'єзоелектричних ефектів в елементарних і бінарних напівпровідниках (спільно з Луцьким технічним університетом), напрямок наукових досліджень – нелінійні вольт-амперні характеристики, плазмові нестійкості.

Виконував обов'язки члена (2002-2004 рр.) та голови (2008-2010 рр.) предметної комісії з «Фізики».

У 2005-2008 рр. – докторант (очної форми навчання) кафедри фізики твердого тіла ВНУ імені Лесі Українки. 2008-2012 рр. – доцент кафедри фізики твердого тіла та інформаційно-вимірювальних технологій (реорганізація кафедри фізики твердого тіла 2011 р.) Волинського національного університету імені Лесі Українки.

З 2012-2015 рр. – декан фізичного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

З 01.09.2015 р. по сьогодні – професор, завідувач кафедри експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій.

Брав участь в роботі Малої академії наук і в інших науково-педагогічних заходах пов'язаних з підвищенням ефективності навчального процесу в школі і виявленню найбільш обдарованої учнівської молоді – член журі обласних конкурсів-захистів наукових робіт, турнірів юних фізиків, турнірів юних винахідників та раціоналізаторів, Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. Член оргкомітету Міжнародної наукової конференції «Релаксаційні, нелінійні й акустооптичні процеси та матеріали».

Член Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка (НТШ).

Член оргкомітету

- Міжнародної наукової конференції «Релаксаційні, нелінійні й акустооптичні процеси та матеріали, РНАОПМ», 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 рр.;
- Всеукраїнського семінару з теоретичної та математичної фізики ТМФ'2009, до 80-річчя професора А. В. Свідзинського;
- Міжнародної науково-практичної конференції «Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки», 2013 р.

Заступник голови оргкомітету

- Всеукраїнського семінару з теоретичної та математичної фізики ТМФ'2014, до 85-річчя професора А. В. Свідзинського;
- Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми фундаментальних наук, АПФН'2015».

Голова оргкомітету

- Міжнародної наукової конференції «Релаксаційні, нелінійні й акустооптичні процеси та матеріали, РНАОПМ», 2014 р.;
- Міжнародної інтернет-конференції молодих учених та студентів «Актуальні проблеми фундаментальних і прикладних досліджень», 2015 р.

У співпраці з іншими членами кафедри є укладачем видань «Фізика: тестові завдання для вступників», навчальних та навчально-методичних видань з дисциплін навчального плану підготовки фахівців спеціальностей «Фізика», «Прикладна фізика», «Хімія», «Біологія». Автор понад 150 наукових статей.

Досвідчений користувач: MS Office (Word, Excel, Power Point, Access, Outlook), навички роботи з Інтернетом (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox) і електронною поштою (Outlook Express), графічними редакторами (Photoshop, CorelDRAW, Origin). Знання операційних систем Windows і Linux.

Перелік навчальних дисциплін, які викладає:

Для студентів ОКР «Бакалавр»:

- «Основи метрології»,
- «Загальна фізика (фізика атома)»,
- «Основи метрології та фізичних вимірювань»,
- «Фізика напівпровідників і діелектриків»,
- «Прикладна механіка»,
- «Радіаційна фізика твердого тіла»,

Керує написанням курсових, дипломних та магістерських робіт.

Нагороди / почесні звання

- Подяка Міністерства освіти і науки України, 2015 р.
- Подяка Національного центру «Мала академія наук України»
(Н № 215 від 13.11.2012 р.)
- Грамота Управління освіти і науки облдержадміністрації
(Н № 40-к від 06.05.2010 р.)
- Подяка Управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації
(Н № 143 від 05.03.2012 р.); (Н № 97 від 27.02.2014 р.)
- Грамота Волинської обласної державної адміністрації Управління освіти і науки
(Н № 68-к від 08.05.2014 р.)
- Грамота ректора Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2013 р.

- Подяка ректора Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2015 р.

II. ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ПРОФЕСОРА С. А. ФЕДОСОВА

Дисертації та автореферати дисертацій 1999

1. Федосов С. А. Вплив структурних дефектів радіаційного походження на фотоелектричні властивості антимоніду і сульфід кадмію : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Федосов Сергій Анатолійович ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1999. – 19 с.
2. Федосов С. А. Вплив структурних дефектів радіаційного походження на фотоелектричні властивості антимоніду і сульфід кадмію : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Федосов Сергій Анатолійович ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1999. – 148 арк.

2013

3. Федосов С. А. Властивості багатодолинних напівпровідників зі структурними дефектами технологічного і радіаційного походження : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Федосов Сергій Анатолійович ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – 40 с.
4. Федосов С. А. Властивості багатодолинних напівпровідників зі структурними дефектами технологічного і радіаційного походження : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Федосов Сергій Анатолійович ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – 388 арк.

Навчально-методичні видання, практикуми, задачі

2002

5. Операційна система Windows 98 та менеджер файлів Windows Commander : метод. рек. для лаборатор. робіт з курсу «Інформатика та комп'ютерна техніка». – Луцьк : РВВ «Вежа» ВДУ ім. Лесі Українки, 2002. – 56 с.

Співавт.: Я. М. Мамчич.

2003

6. Фізика : тестові завдання для вступників. – [4-те вид.]. – Луцьк : РВВ «Вежа» ВДУ ім. Лесі Українки, 2003. – 135 с.

Співавт.: М. С. Богданюк, В. В. Божко, О. М. Бірук, В. П. Доскоч, О. С. Мартинюк, Г. П. Шаварова.

2004

7. Операційна система Windows 2000 та менеджер файлів Total Commander : метод. рек. для лаборатор. робіт з курсу «Інформатика та комп'ютерна техніка». – Луцьк : РВВ «Вежа» ВДУ ім. Лесі Українки, 2004. – 62 с.

Співавт.: Я. М. Мамчич.

2005

8. Механіка : метод. рек. для проведення лаборатор. занять зі студентами хім. спец. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ «Вежа» ВДУ ім. Лесі Українки, 2005. – 58 с. : іл. – Додатки. – Бібліогр.: с. 52.

Співавт.: А. Г. Кевшин, Г. П. Шаварова.

9. Операційна система Windows 2000 та менеджер файлів Total Commander : метод. рек. для лаборатор. робіт з курсу «Інформатика та комп'ютерна техніка» / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ «Вежа» ВДУ ім. Лесі Українки, 2005. – 68 с. : рис. – Бібліогр.: с. 66.

Співавт.: Я. М. Мамчич.

2006

10. Електрика : метод. рек. для лаборатор. робіт студентам нефіз. спец. вищих навч. закл. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ «Вежа» ВДУ ім. Лесі Українки, 2006. – 120 с. : рис., табл.

Співавт.: Г. П. Кобель, В. В. Галян, А. Г. Кевшин.

2007

11. Фізика : тестові завдання для вступників / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – [5-те вид.]. – Луцьк : РВВ «Вежа» ВДУ ім. Лесі Українки, 2007. – 148 с.

Співавт.: М. С. Богданюк, В. В. Божко, О. М. Бірук, В. П. Доскоч, О. С. Мартинюк, В. П. Муляр, Г. П. Шаварова.

2010

12. Оптика : метод. рек. для лаборатор. робіт з курсу фізики студентам нефіз. спец. вищ. навч. закл. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Фіз. ф-т. – Луцьк : РВВ «Вежа» ВДУ ім. Лесі Українки, 2010. – 102 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 99-100.

Співавт.: А. Г. Кевшин, В. В. Галян, А. П. Третяк.

2011

13. Загальна фізика. Механіка, молекулярна фізика і термодинаміка : метод. вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.050902 «Радіоелектронні апарати» денної та заочної форм навчання. – Луцьк : ЛБІ МНТУ, 2011. – 62 с.

14. Основні вимоги до структури та оформлення курсових робіт : метод. вказівки для студентів напряму підготовки 6.050902 «Радіоелектронні апарати» денної та заочної форм навчання. – Луцьк : ЛБІ МНТУ, 2011. – 15 с.

2013

15. Фізика : метод. рек. до лаборатор. робіт з фізики для студентів спец. «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 88 с.

Співавт.: А. Г. Кевшин, В. В. Галян.

2014

16. Фізика : метод. рек. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 88 с.

Співавт.: А. Г. Кевшин, В. В. Галян.

17. Фізика : метод. вказівки і контрольні завдання для студентів нефіз. спец. заочної форми навч. – Луцьк : Іванюк В. П., 2014. – 60 с.

Співавт.: А. Г. Кевшин, В. В. Галян.

18. Фізика. Ч. 1 : метод. рек. до лаборатор. робіт з фізики студентам спец. «Біологія» СНУ ім. Лесі Українки. – Луцьк : Іванюк В. П., 2014. – 56 с.

Співавт.: А. Г. Кевшин, В. В. Галян.

19. Фізика. Ч. 2 : метод. рек. до лаборатор. робіт з фізики студентам спец. «Біологія» СНУ ім. Лесі Українки. – Луцьк : Іванюк В. П., 2014. – 64 с.

Співавт.: А. Г. Кевшин, В. В. Галян.

2015

20. Основи метрології : Похибки вимірювань. Обробка результатів вимірювань : метод. рек. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 44 с.

Співавт.: А. Г. Кевшин, П. П. Шигорін.

21. Основи метрології. Ч. 1. Фізичні величини та одиниці їх вимірювання. Види, методи та засоби вимірювань : навч. посіб. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 48 с.

Співавт.: А. Г. Кевшин, П. П. Шигорін.

22. Фізика : метод. вказівки. – Луцьк : Іванюк В. П., 2015. – 56 с.

Співавт.: А. Г. Кевшин, В. В. Галян.

2016

23. Радіотехнічні кола та сигнали : курс лекцій / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 100 с.

Співавт.: О. В. Новосад.

24. Фізика напівпровідників. У 3 ч. Ч. 2. Концентрація носіїв при тепловій рівновазі. Явища перенесення носіїв : курс лекцій / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 60 с.

Співавт.: О. В. Замуруєва, Д. А. Захарчук.

25. Фізика напівпровідників. У 3 ч. Ч. 3. Фононі, оптичні та теплові властивості. Гетеропереходи та наноструктури. Основні рівняння та приклади : курс лекцій / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 39 с.

Співавт.: О. В. Замуруєва, Ю. В. Коваль.

26. Фізика твердого тіла : практикум / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 49 с.

Співавт.: А. П. Третяк, В. В. Галян, А. М. Коровицький.

2017

27. Технічна механіка : практикум / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 80 с.

Співавт.: О. В. Новосад, М. С. Богданюк.

28. Фотонні пристрої та сенсори. Ч. 1. Світлодіоди : курс лекцій / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 42 с.

Співавт.: О. В. Замуруєва, Д. А. Захарчук, А. М. Коровицький.

2018

29. Асистентська практика : програма виробничої практики / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Каф. експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 5 с.

30. Електрика і магнетизм : метод. рек. до лаборатор. робіт / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 100 с.

Співавт.: О. В. Новосад, В. В. Божко.

31. Магістерський семінар : програма норматив. навч. дисципліни / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Каф. експериментальної фізики та інформаційно-вимірювал. технологій. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 5 с.

32. Основи теорії кіл, сигнали та процеси в електроніці : курс лекцій / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 100 с.

Співавт.: О. В. Новосад.

33. Педагогічна практика у ВНЗ : програма виробничої практики / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Каф. експериментальної фізики та інформаційно-вимірювал. технологій. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 5 с.

Співавт.: Н. А. Головіна.

34.Педагогічна практика у СНЗ : програма виробничої практики / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Каф. експериментальної фізики та інформаційно-вимірjuвал. технологій. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 6 с.

Співавт.: Н. А. Головіна.

35.Переддипломна практика : програма виробн. практики / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Каф. експериментальної фізики та інформаційно-вимірjuвал. технологій. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 5 с.

36.Практика на виробництві : програма виробничої практики / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Каф. експериментальної фізики та інформаційно-вимірjuвал. технологій. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 5 с.

Співавт.: Г. П. Шаварова.

37.Фізика напівпровідників. У 3 ч. Ч. 1. Кристалічна структура. Енергетичні зони та енергетична щілина : курс лекцій / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 45 с.

Співавт.: В. Є. Сахнюк, В. В. Галян, А. М. Коровицький.

38.Фотонні пристрої та сенсори. Ч. 3. Фотодетектори : курс лекцій / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 58 с.

Співавт.: О. В. Замуруєва, П. П. Шигорін, Ю. В. Коваль.

39.Фотонні пристрої та сенсори. Ч. 4. Сонячні елементи : курс лекцій / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 39 с.

Співавт.: О. В. Замуруєва, Д. А. Захарчук, В. В. Галян.

40.Фотопровідність у напівпровідниках : навч. посіб. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 110 с.

Співавт.: Г. Л. Мирончук, І. В. Кітик, А. М. Коровицький, А. Г. Кевшин.

2019

41.Структурні елементи напівпровідникових пристроїв. Ч. 1. *p-n* переходи : курс лекцій / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – 84 с.

Співавт.: О. В. Замуруєва, Д. А. Захарчук, А. Г. Кевшин, О. В. Новосад.

42. Структурні елементи напівпровідникових пристроїв. Ч. 2. Контакти метал-напівпровідник : курс лекцій / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – 92 с.

Співавт.: О. В. Замуруєва, В. Є. Сахнюк, О. В. Новосад, А. М. Коровицький.

2020

43. Електричні машини : конспект лекцій / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2020. – 62 с.

Співавт.: А. Г. Кевшин, В. В. Галян.

44. Електроніка : задачі / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2020. – 48 с.

Співавт.: А. Г. Кевшин, О. В. Новосад.

45. Електроніка : метод. рек. до лаборатор. робіт / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2020. – 87 с.

Співавт.: О. В. Новосад, В. В. Божко, А. Г. Кевшин.

46. Електротехніка. У 2 ч. Ч. 1. Кола постійного струму. Лінійні кола змінного струму. Трифазні кола електричного струму : задачі / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2020. – 39 с.

Співавт.: А. Г. Кевшин, В. В. Галян.

47. Електротехніка. У 2 ч. Ч. 2. Трансформатори. Комплексний метод розрахунку електричних кіл синусоїдного струму : задачі / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2020. – 33 с.

Співавт.: А. Г. Кевшин, В. В. Галян.

48. Інформаційний пошук і робота з бібліотечними ресурсами : навч. посіб. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2020. – 136 с.

Співавт.: Ж. О. Кормош, С. В. Супрунович, О. В. Замуруєва.

49. Практикум з математичного аналізу: кратні та криволінійні інтеграли / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2020. – 42 с.

Співавт.: В. Є. Сахнюк, А. М. Шутовський.

50. Структурні елементи напівпровідникових пристроїв : задачі / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2020. – 32 с.

Співавт.: О. В. Замуруєва, В. Є. Сахнюк, Д. А. Захарчук, А. Г. Кевшин, О. В. Новосад.

51. Фізика : задачі / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2020. – 68 с.

Співавт.: А. Г. Кевшин, В. В. Галян.

52. Фізика : метод. рек. до лаборатор. робіт / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2020. – 63 с.

Співавт.: А. Г. Кевшин, В. В. Галян.

53. Фізика напівпровідників : задачі / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2020. – 24 с.

Співавт.: О. В. Замуруєва, В. Є. Сахнюк, Д. А. Захарчук, Ю. В. Коваль.

2021

54. Структурні елементи напівпровідникових пристроїв : навч. посіб. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2021. – 88 с.

Співавт.: О. В. Замуруєва, О. Ю. Хижун, В. Є. Сахнюк.

Статті у продовжуваних, періодичних та неперіодичних виданнях
1994

55. Вплив радіаційних дефектів на деякі електричні і оптичні властивості монокристалів антимоніду кадмію // Наукові нотатки. Серія фізико-математичних наук : міжвуз. зб. / Луцький індустр. ун-т. – Луцьк, 1994. – № 2. – С. 70–81.

Співавт.: Г. Є. Давидюк, В. В. Божко, В. П. Доскоч, М. С. Богданюк, З. В. Панкевич.

56. Температурно-електрична нестійкість в монокристалах CdSb, опромінених швидкими нейтронами // Наукові нотатки. Серія фізико-математичних наук : міжвуз. зб. / Луцький індустр. ун-т. – Луцьк, 1994. – № 2. – С. 91–92.

Співавт.: В. П. Доскоч, М. С. Богданюк, В. В. Божко, Г. Є. Давидюк.

1996

57. Влияние радиационных дефектов на некоторые электрические и оптические свойства монокристаллов антимонида кадмия = Effect of Radiation-induced Defects on the Electrical and Optical Properties of Cadmium Antimonide Single Crystals // Неорганические материалы : журн. Рос. акад. наук / Отд-ние химии и наук о материалах РАН ; гл. ред. К. А. Солнцев. – М., 1996. – Т. 32, № 11. – С. 1166–1170.

Соавт.: Г. Е. Давидюк, В. В. Божко, А. И. Раренко, В. П. Доскоч, Н. С. Богданюк.

1997

58. Фотопровідність опромінених електронами монокристалів сульфїду кадмію, легованих міддю // Наук. вісн. ВДУ / Волин. держ. ун-т ім. Лесі України ; голов. ред. І. Д. Олексеюк. – Луцьк, 1997. – № 4 : Фізичні, хімічні, математичні науки, інформатика. – С. 8-13.

Співавт.: В. Божко, В. Галян, В. Троцюк.

1998

59. Особенности фотопроводимости облученных быстрыми электронами с $E=1,2$ МэВ монокристаллов сульфида кадмия, легированных медью //

Фотоелектроніка = Photoelectronics : межведомств. науч. сб. / Одес. гос. ун-т ім. І. І. Мечникова ; редкол.: В. А. Сминтина (ред.) [и др.]. – Одесса, 1998. – Вып. 7. – С. 29–30.

Соавт.: Г. Е. Давидюк, В. В. Божко.

60. Природа і відпал центрів швидкої рекомбінації в опромінених електронами з енергією $E=1,2$ МеВ монокристалах сульфїду кадмію // Наук. вісн. ВДУ / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки ; голов. ред. І. Д. Олексеюк. – Луцьк, 1998. – № 6 : Фізичні, хімічні, математичні науки. – С. 31-36.

Співавт.: Г. Є. Давидюк, В. П. Доскоч, Г. П. Шаварова, В. А. Войтович.

61. Утворення швидких центрів рекомбінації при електронному опроміненні спеціально нелегованих і легованих міддю монокристалів сульфїду кадмію // Наук. вісн. ВДУ / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки ; голов. ред. І. Д. Олексеюк. – Луцьк, 1998. – № 6 : Фізичні, хімічні, математичні науки. – С. 25-31.

Співавт.: Г. Є. Давидюк, М. С. Богданюк, Г. П. Шаварова, В. А. Войтович.

1999

62. Відпал дефектів в нейтронно опромінених монокристалах Cd Sb // Наук. вісн. ВДУ / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки ; голов. ред. Г. Є. Давидюк. – Луцьк, 1999. – № 14 : Фізичні науки. – С. 56-61.

Співавт.: Г. Є. Давидюк, В. П. Доскоч.

2001

63. Вплив радіаційних дефектів на провідність n-Ge при одновісній пружній деформації // Фізичний збірник / Наук. т-во ім. Шевченка ; відп. ред. Я. Довгий [та ін.]. – Львів, 2001. – Т. 4 : На пошану Олександра Смакули. – С. 129–134.

Співавт.: А. Федосов, М. Хвищун, Л. Ящинський.

64. Особливості п'єзоопору германію в області власної провідності // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Г. Є. Давидюк та ін.]. – Луцьк, 2001. – № 7 : Фізичні науки. – С. 26–30.

Співавт.: А. В. Федосов, М. В. Хвищун, Д. А. Захарчук.

65. Особливості п'єзоопору Ge при наявності глибоких рівнів та в області власної провідності // Вісн. Львів. ун-ту. Серія фізична / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; [редкол.: І. Вакарчук (відп. ред.) та ін.]. – Львів, 2001. – № 34. – Р. 85–93.

Співавт.: М. В. Хвищун, Д. А. Захарчук.

2003

66. Визначення зміни глибини залягання електрично активного рівня у уопромінену *n*-Si при одновісній пружній деформації // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки ; голов. ред. І. Д. Олексеюк. – Луцьк, 2003. – № 11. – С. 11–16.

Співавт.: А. В. Федосов, М. В. Хвищун, А. М. Коровицький, Д. А. Захарчук.

2004

67. Влияние слоистых периодических неоднородностей на пьезосопротивление γ -облученных монокристаллов *n*-Si и *n*-Ge // Наукоемкие технологии : науч.-техн. журн. / ред. А. П. Реутов. – М., 2004. – Т. 5, № 6. – С. 27–31.

Соавт.: А. В. Федосов, Л. В. Ящинський, Д. А. Захарчук, Н. В. Хвищун.

68. Особливості впливу ізовалентної домішки германію на неоднорідність питомого опору у кристалах кремнію = Features of Effect of an Isovalent Impurity Germanium on a Non-Uniformity of Specific Resistance in Crystals of Silicon // Вісн. Львів. ун-ту. Серія фізична / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; відп. ред. І. Вакарчук. – Львів, 2004. – Вип. 37. – С. 140–145.

Співавт.: М. Хвищун, Д. Захарчук, Л. Ящинський, А. Коровицький, Ю. Коваль.

69. Розрахунок величини зміщення рівнів радіаційних дефектів у γ -опромінених монокристалах *n*-Si // Нові технології: наук. вісн. Ін-ту економіки та нових технологій ім. Ю. І. Кравченка / Ін-т економіки та нових технологій ім. Ю. І. Кравченка. – Кременчук, 2004. – № 1/2. – С. 16–18.

Співавт.: А. В. Федосов, Д. А. Захарчук, М. В. Хвищун.

2005

70. Вплив донорної домішки SbI_3 на деякі електрофізичні параметри твердих розчинів n-типу $(\text{Bi}_2\text{Te}_3)_{0,9}(\text{Sb}_2\text{Te}_3)_{0,05}(\text{Sb}_2\text{Se}_3)_{0,05} + 0,5$ ваг. % Te // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки ; відп. ред.: М. В. Моклиця, Г. Є. Давидюк, М. І. Карлін. – Луцьк, 2005. – № 1. – С. 21–25.

Співавт.: А. В. Федосов, О. Ф. Семізоров, А. М. Йонік.

71. Вплив шарів росту на електричні ефекти в монокристалах антимоніду кадмію, легованих телуrom // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2005. – № 237: Фізика. Електроніка. – С. 60–62.

Співавт.: А. В. Федосов, Ю. В. Коваль, Л. В. Ящинський, А. М. Йонік.

2006

72. Ефект перемикування в кристалах CdSb , легованих Te // Вісн. Львів. ун-ту. Серія фізична / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; відп. за вип. І. Болеста. – Львів, 2006. – Вип. 39. – С. 268–272.

Співавт.: Ю. Коваль, Л. Ящинський.

73. Influence of Illumination on Parameter Change of Anisotropy of Mobility in n-Ge Monocrystals with Heterogeneous Distribution of Doping Impurity // Photoelectronics. – 2006. – № 15. – P. 105–107.

Soauthor: A. V. Fedosov, D. A. Zakharchuk, R. N. Semchenko.

2007

74. Визначення глибини залягання глибоких рівнів у n-Si методом п'єзоопору // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки ; голов. ред. І. Я. Коцан. – Луцьк, 2007. – № 16. – С. 43–44. – Бібліогр.: 5 назв.

Співавт.: А. В. Федосов, Д. А. Захарчук, Р. М. Семенченко, С. В. Луньов.

75. Визначення глибини залягання енергетичних рівнів у забороненій зоні напівпровідників на основі досліджень ефекту п'єзоопору // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі

Українки ; голов. ред. І. Я. Коцан. – Луцьк, 2007. – № 6 : Фізичні науки. – С. 37-40.

Співавт.: А. В. Федосов, Ю. В. Коваль, Л. В. Ящинський.

76. Дослідження глибоких енергетичних рівнів у монокристалах антимоніду кадмію, легованих телуrom, до і після γ -опромінення // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки ; голов. ред. І. Я. Коцан. – Луцьк, 2007. – № 16. – С. 45–47. – Бібліогр.: 3 назви.

Співавт.: А. В. Федосов, Ю. В. Коваль, Л. В. Ящинський, Д. А. Захарчук.

2008

77. Визначення швидкості зміщення глибоких енергетичних рівнів у монокристалах кремнію при одновісній пружній деформації // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 18 : Фізичні науки. – С. 54-57.

Співавт.: А. В. Федосов, С. В. Луньов, Д. А. Захарчук, В. С. Тимощук.

78. Вплив глибоких енергетичних рівнів на електрофізичні властивості монокристалів n-Si // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; голов. ред. Г. Є. Давидюк. – Луцьк, 2008. – № 9 : Фізичні науки. – С. 54-57.

Співавт.: А. В. Федосов, Д. А. Захарчук, Ю. В. Коваль, Л. І. Панасюк.

79. Дослідження кінетичних ефектів в монокристалах антимоніду кадмію при різних фізико-активних впливах // Нові технології: наук. вісн. Кременчуц. ун-ту економіки, інформаційних технологій і управління / Кременчуцький ун-т економіки, інформаційних технологій і управління. – Кременчук, 2008. – № 2(20). – С. 158–163.

Співавт.: А. В. Федосов, Ю. В. Коваль, Л. В. Ящинський, Д. А. Захарчук

2009

80. Визначення констант зсуву деформаційного потенціалу в γ -опроміненому германії та кремнії // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Г. Є. Давидюк [та ін.]. – Луцьк, 2009. – № 18 : Фізичні науки. – С. 3–7.

Співавт.: А. В. Федосов, С. В. Луньов, Д. А. Захарчук, Л. І. Панасюк.

81. Вплив глибоких енергетичних рівнів на тензоефекти у кристалах $n\text{-Ge}\langle\text{Au}\rangle$ // Наукові нотатки : міжвуз. зб. / Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2009. – № 25, ч. 2. – С. 301–303.

Співавт.: А. В. Федосов, С. В. Луньов, Д. А. Захарчук, Л. І. Панасюк.

82. Вплив неоднорідностей в розподілі легуючої домішки Te на фізичні властивості монокристалів CdSb // Наукові нотатки : міжвуз. зб. / Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2009. – № 25, ч. 1. – С. 392–394.

Співавт.: А. В. Федосов, Ю. В. Коваль, Л. В. Ящинський.

83. Вплив одновісної пружиної деформації на положення глибоких енергетичних рівнів у монокристалах $n\text{-Si}(\text{Ge})$ // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Г. Є. Давидюк [та ін.]. – Луцьк, 2009. – № 18 : Фізичні науки. – С. 8-11. – Бібліогр.: 4 назви.

Співавт.: А. В. Федосов, С. В. Луньов, А. М. Коровицький, С. Я. Місюк.

2010

84. Визначення константи деформаційного потенціалу $[I]d$ в $n\text{-Ge}$ методом п'єзоопору // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Г. Є. Давидюк та ін.]. – Луцьк, 2010. – № 6 : Фізичні науки. – С. 38-44. – Бібліогр.: 7 назв.

Співавт.: А. В. Федосов, С. В. Луньов.

85. Вплив концентрації домішок на зміну положення глибокого рівня $E_C - 0,2$ еВ при одновісно пружній деформації в $n\text{-Ge}\langle\text{Au}\rangle$ // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Г. Є. Давидюк та ін.]. – Луцьк, 2010. – № 29 : Фізичні науки. – С. 37-43. – Бібліогр.: 9 назв.

Співавт.: М. В. Хвищун, С. В. Шинкарук.

86. Особенности междолинного рассеяния носителей тока в $n\text{-Si}$ при высоких температурах = Specific Features of Intervalley Scattering of Charge Carriers in $n\text{-Si}$ at High Temperatures // Физика и техника полупроводников : науч.

журн. / РАН, Фізико-техн. ін-т ім. А. Ф. Иоффе РАН. – М., 2010. – Т. 44, № 10. – С. 1307–1309. – Библиогр.: 11 назв.

Співавт.: А. В. Федосов, С. В. Лунёв.

87. Особливості п'єзоопору γ -опромінених кристалів n-Si у випадку симетричного розміщення осі деформації відносно всіх ізоенергетичних еліпсоїдів = Peculiarities of Piezoresistance of γ -irradiated n-Si Crystals in the Case of Symmetric Position of the Deformation Axis Relative to All Isoenergetic Ellipsoids // Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics : наук. журн. / Нац. акад. наук України, від-ня фізики і астрономії, Ін-т теорет. фізики ім. М. М. Боголюбова. – Київ, 2010. – Т. 55, № 3. – С. 322–326.

Співавт.: А. В. Федосов, С. В. Луньов.

88. Підвищення рухливості носіїв струму в одновісно деформованих кристалах n-Si та n-Si з ізовалентною домішкою германію = The Increasing of Carriers Current Mobility in Uniaxial Deformed Crystals n-Si and n-Si with the Isovalent Impurity of Germanium // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor electronics and microsystem technologies : наук.-техн. журн. / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 1(7), № 3. – С. 65–68.

Співавт.: А. В. Федосов, С. В. Луньов, С. Я. Місюк, А. М. Коровицький.

89. Роль деформації кристалічної ґратки монокристалів сульфід кадмію в зміні параметрів центрів випромінювальної рекомбінації // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Г. Є. Давидюк та ін.]. – Луцьк, 2010. – № 6 : Фізичні науки. – С. 3-10. – Бібліогр.: с. 9-10.

Співавт.: Г. Є. Давидюк, М. С. Богданюк, Г. П. Шаварова.

2011

90. Визначення константи деформаційного потенціалу Ξ_d в n-Si методом п'єзоопору = Determining the Deformation Potential Constant Ξ_d in n-Si by the Method of Piezoresistance // Журнал фізичних досліджень = Journal of

Physical Studies : наук. журн. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2011. – Т. 15, № 2. – С. 2705-1–2705-4.

Співавт.: С. Луньов.

91. Вплив одновісної деформації на заповнення рівня, пов'язаного з А-центром, у кристалах n-Si = Influence of Uniaxial Deformation on the Filling of the Level Associated with A-Center in n-Si Crystals // Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics : наук. журн. / Нац. акад. наук України, від-ня фізики і астрономії, Ін-т теорет. фізики ім. М. М. Боголюбова. – Київ, 2011. – Т. 56, № 1. – С. 70–74.

Співавт.: А. В. Федосов, С. В. Луньов.

92. Вплив одновісної пружної деформації на положення глибоких енергетичних рівнів у монокристалах n-Ge<Au> // Праці Наукового товариства ім. Шевченка / Наук. т-во ім. Шевченка ; редкол.: Р. Кушнір (голов. ред.) [та ін.]. – Львів, 2011. – Т. 8 : Фізичний збірник. – С. 205–209. – Бібліогр.: 4 назви.

Співавт.: А. Федосов, С. Луньов, Д. Захарчук, Л. Панасюк.

93. Вплив одновісної пружної деформації на положення та ступінь заповнення глибокого рівня $E_C - 0,2$ еВ у монокристалах n-Ge<Au> // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Г. Є. Давидюк та ін.]. – Луцьк, 2011. – № 16 : Фізичні науки. – С. 39-45. – Бібліогр.: 13 назв.

Співавт.: С. В. Луньов, Д. А. Захарчук, Л. І. Панасюк, Ю. В. Коваль.

94. Фізичні властивості монокристалів антимоніду кадмію в полях ефективного зовнішнього впливу // Перспективні технології та прилади : зб. наук. пр. / Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2011. – Вип. 1. – С. 239–248. – Бібліогр.: 4 назви.

Співавт.: Л. В. Яцинський, Ю. В. Коваль, Д. А. Захарчук, Л. В. Коваль.

95. Silicon p-MOS and n-MOS Transistors with Uniaxially Strained Channels in Electronic Device Nanotechnology // Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics : наук. журн. / Нац. акад. наук України, від-ня

фізики і астрономії, Ін-т теорет. фізики ім. М. М. Боголюбова. – Київ, 2011. – Vol. 56, № 9. – P. 917–921.

Soauthor: A. E. Gorin, G. V. Gromova, V. M. Ermakov, P. P. Kogutyuk, V. V. Kolomoets, P. F. Nazarchuk, L. I. Panasjuk.

2012

96. Дослідження неоднорідностей в монокристалах антимоніду кадмію // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля : наук. журн. / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; редкол.: О. В. Поркуян (голов. ред.) [та ін.]. – Северодонецьк, 2012. – Ч. 2, № 14(185). – С. 80–83.

Співавт.: Ю. В. Коваль, Л. В. Ящинський, Д. А. Захарчук.

97. Константи деформаційного потенціалу Ξ_u and Ξ_d у n-Si, визначені методом тензорезистивного ефекту = Deformation Potential Constants Ξ_u and Ξ_d in n-Si Determined with the Use of the Tensorsistance Effect // Український фізичний журнал = Ukrainian journal of physics : наук. журн. / Нац. акад. наук України, від-ня фізики і астрономії, Ін-т теорет. фізики ім. М. М. Боголюбова. – Київ, 2012. – Т. 57, № 6. – С. 637–642. – Бібліогр.: 18 назв.

Співавт.: С. В. Луньов, Л. І. Панасюк.

98. Тензорезистивний ефект в γ -опромінених монокристалах n-Ge при освітленні // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля : наук. журн. / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; редкол.: О. В. Поркуян (голов. ред.) [та ін.]. – Северодонецьк, 2012. – Ч. 2, № 14(185). – С. 54–57.

Співавт.: Д. А. Захарчук, Ю. В. Коваль, Л. В. Ящинський.

2013

99. Іоноселективні електроди з плівковою мембраною на основі тетраїodobісмутату та тетраїодостибіату для визначення N, N', N''-трифенілгуанідинію // Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; голов. ред. І. Я.

Коцан. – Луцьк, 2013. – № 24(273): Хімічні науки. – С. 66-73.

Співавт.: Ж. Кормош, Н. Зубеня.

100. Потенціометричне визначення індоліл-3-оцтової кислоти за допомогою ПВХ сенсора з родаміновими основними барвниками // Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; голов ред. І. Я. Коцан. – Луцьк, 2013. – № 24(273): Хімічні науки. – С. 78-84.

Співавт.: Ж. Кормош, К. Журба.

101. Потенціометричний сенсор для визначення фенілантранілової кислоти // Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; голов ред. І. Я. Коцан. – Луцьк, 2013. – № 24(273): Хімічні науки. – С. 49–53.

Співавт.: Ж. Кормош, О. Матвійчук.

102. Application of high uniaxial strain methods for semiconductor parameter determination // Physica B: Condensed Matter. – 2013. – Vol. 417. – P. 46–48.

Soautor: V. Kolomoets, V. Ermakov, L. Panasyuk, B. Orasgulyev, P. Nazarchuk.

DOI: <https://doi.org/10.1016/j.physb.2013.02.017>

2014

103. Анізотропія тензорезистивних ефектів у сильно легованих кристалах р-Si(B) в області σ_2 -провідності // Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: С. А. Федосов (голов. ред.) [та ін.]. – Луцьк, 2014. – № 17(294) : Фізичні науки. – С. 3–7.

Співавт.: В. Коломоєць, Л. Панасюк, В. Єрмаков.

104. Взаємодія компонентів AgSbSe_2 і PbSe й термоелектричні властивості твердих розчинів на їх основі // Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: С. А. Федосов (голов. ред.) [та ін.]. – Луцьк, 2014. – № 17(294) : Фізичні науки. – С. 8–14.

Співавт.: Н. Божко, О. Новосад, Т. Остап'юк, О. Змій, П. Торчинюк, І. Олексєюк, Н. Іллюшко.

105. Changing of the Anisotropy Parameter of Mobility in n-Ge Single Crystals with Heterogeneous Distribution of Doping Impurity // Journal of Nuclear Physics At. Energy. – 2014. – Vol. 15, № 1. – P. 66–69.

Soautor: D. A. Zakharchuk, Yu. V. Koval, L. V. Yashchynskiy.

2015

106. Енергія активації технологічних термодонорів у нейтронно-легованому кремнії = Activation Energies of Technological Termodonors in Neutron Doped Silicon // Журнал фізичних досліджень = Journal of Physical Studies : наук. журн. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2015. – Т. 19, чис. 1/2. – С. 1701-1–1701-3. – Бібліогр.: 6 назв.

Співавт.: Л. І. Панасюк, В. В. Коломоєць, В. М. Єрмаков, Л. В. Ящинський.

107. Механізми тензоефектів у нейтронно-легованому γ -опромінену p-Si(P) при сильних одновісних тисках // Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: С. А. Федосов (голов. ред.) [та ін.]. – Луцьк, 2015. – № 10 : Серія: Фізичні науки. – С. 3–7. – Бібліогр.: 10 назв.

Співавт.: Л. Панасюк, В. Коломоєць.

108. Морфометрія та механічні властивості плівок карбону, отриманих магнетронним депонуванням в атмосфері аргону // Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: С. А. Федосов та ін.]. – Луцьк, 2015. – № 10(311) : Серія: Фізичні науки. – С. 33–40. – Бібліогр.: 6 назв.

Співавт.: А. Коровицький, Д. Чосік, Ю. Качан, І. Колядинський, В. Сахарчук.

2016

109. Вплив температури на оптичні властивості стекол $\text{Ag}_{0.05}\text{Ga}_{0.05}\text{Ge}_{0.95}\text{S}_2$, легуваних ербієм = Temperature Influence on the Optical Properties of Erbium-Doped $\text{Ag}_{0.05}\text{Ga}_{0.05}\text{Ge}_{0.95}\text{S}_2$ Glasses // Журнал фізичних досліджень = Journal of Physical Studies : наук. журн. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2016. – Т. 20, № 3. – С. 3401-1–3401-4. – Бібліогр.: 11 назв.

Співавт.: В. В. Галян, А. Г. Кевшин, М. В. Шевчук, П. П. Шигорін.

2017

110. Effect of Uniaxial Pressure on the σ_2 -conductivity of Heavily Doped p-Si(B) // Journal of nano- and electronic physics = Журнал нано- та електронної фізики / ed. board: I. Yu. Protsenko (ed.-in-chief) [et al.] ; Sumy State Univ. – Sumy, 2017. – Vol. 9, № 1. – P. 01020-1–01020-5.

Soautor: L. I. Panasjuk, V. V. Kolomoets, V. M. Ermakov.

DOI: [10.21272/jnep.9\(1\).01020](https://doi.org/10.21272/jnep.9(1).01020)

111. Features of Structural Inhomogeneities in Doped Cadmium Antimonide Crystals // Physics and Chemistry of Solid State / Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. – Ivano-Frankivsk, 2017. – Vol. 18, № 3. – P. 321–323.

Soautor: Yu. V. Koval, D. A. Zakharchuk, L. V. Yashchinskiy, L. I. Panasjuk.

DOI: [10.15330/pcss.18.3.312-323](https://doi.org/10.15330/pcss.18.3.312-323)

2018

112. Електричні та фотоелектричні властивості кристалів $\text{Pb}_{1-x}\text{Ga}_{1-x}\text{Sn}_x\text{Se}_2$ ($x=0,05; 0,1$) // Перспективні технології та прилади : зб. наук. пр. / Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2018. – № 12. – С. 119–123. – Бібліогр.: 20 назв.

Співавт.: Г. В. Махновець, Г. Л. Мирончук, Л. В. Піскач.

113. Люмінесценція неопроміненого та γ -опроміненого монокристалу $(\text{Ga}_{69,5}\text{La}_{29,5}\text{Er})_2\text{S}_{300}$ // Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань «Технічні науки») / Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2018. – Вип. 64. – С. 23–27. – Бібліогр.: 17 назв.

Співавт.: В. В. Галян, А. Г. Кевшин, І. А. Іващенко, О. О. Лебедь, І. Д. Олексюк, П. В. Тищенко, А. Б. Тимошук.

114. Підвищення фотопровідності кристалів халькогеніду індинату талію (TlInSe_2) // Перспективні технології та прилади : зб. наук. пр. / Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2018. – № 12. – С. 67–71. – Бібліогр.: с. 69–70.

Співавт.: О. В. Замуруєва, А. Г. Кевшин, А. М. Коровицький.

2019

115. Методики та техніки вимірювання іонізації та їх проблематика // Перспективні технології та прилади : зб. наук. пр. / Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2019. – Вип. 14. – С. 159–164. – Бібліогр.: 6 назв.

Співавт.: Ю. П. Шипелик.

DOI: [10.36910/6775-2313-5352-2019-14-27](https://doi.org/10.36910/6775-2313-5352-2019-14-27)

116. Механізм фотолюмінесценції монокристалу $(\text{Ga}_{54.59}\text{In}_{44.66}\text{Er}_{0.75})_2\text{S}_{300}$ // Перспективні технології та прилади : зб. наук. пр. / Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2019. – Вип. 14. – С. 51–57. – Бібліогр.: 23 назви.

Співавт.: В. В. Галян, І. А. Іващенко, І. Д. Олексеюк, А. П. Третяк, І. В. Данилюк, О. О. Лебедь, А. Г. Кевшин, П. В. Тищенко.

DOI: [10.36910/6775-2313-5352-2019-14-8](https://doi.org/10.36910/6775-2313-5352-2019-14-8)

2020

117. Актуальні дослідження в області медичної фізики: виклики для України // Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань «Технічні науки») / Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2020. – № 69. – С. 82–91.

Співавт.: Л. І. Никируй, Я. П. Салій, В. В. Прокопів, О. В. Замуруєва, Р. С. Яворський.

DOI: [10.36910/6775.24153966.2020.69.12](https://doi.org/10.36910/6775.24153966.2020.69.12)

118. Вольт-амперні характеристики поверхнево-бар'єрних структур $\text{In}/\text{CuInS}_2\text{-ZnIn}_2\text{S}_4$ // Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань «Технічні науки») / Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2020. – № 69. – С. 63–67.

Співавт.: О. В. Новосад, В. В. Божко.

DOI: [10.36910/6775.24153966.2020.69.9](https://doi.org/10.36910/6775.24153966.2020.69.9)

119. Вплив наукових досліджень на розвиток відновлювальної енергетики // Перспективні технології та прилади : зб. наук. пр. / Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2020. – Вип. 16. – С. 82–91. – Бібліогр.: 11 назв.

Співавт.: Л. І. Никируй, О. В. Замуруєва, О. А. Урбан.

DOI: [10.36910/6775-2313-5352-2020-16-11](https://doi.org/10.36910/6775-2313-5352-2020-16-11)

120. Науково-технічний прогрес розвитку відновлюваної енергетики в Україні // Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань «Технічні науки») / Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2020. – № 70. – С. 18–26.

Співавт.: Л. І. Никируй, О. В. Замуруєва, В. С. Федосов, О. М. Бірук.

DOI: [10.36910/6775.24153966.2020.70.3](https://doi.org/10.36910/6775.24153966.2020.70.3)

121. Перспективні матеріали і технології сонячних елементів // Перспективні технології та прилади : зб. наук. пр. / Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2020. – Вип. 17. – С. 175–182.

Співавт.: Л. І. Никируй, О. В. Замуруєва, О. В. Новосад.

DOI: [10.36910/6775-2313-5352-2020-17-26](https://doi.org/10.36910/6775-2313-5352-2020-17-26)

122. Прямі і непрямі переходи у кристалічних сполуках $\text{TlInX}_2\text{-SnX}_2$ (X – S, Se) // Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань «Технічні науки») / Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2020. – № 70. – С. 57–64.

Співавт.: С. П. Данильчук, О. В. Замуруєва, В. Є. Сахнюк.

DOI: [10.36910/6775.24153966.2020.70.8](https://doi.org/10.36910/6775.24153966.2020.70.8)

123. Термоелектричні властивості кристалів $\text{AgSbSe}_2\text{-PbSe}$ // Перспективні технології та прилади : зб. наук. пр. / Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2020. – Вип. 17. – С. 183–189.

Співавт.: О. В. Новосад, В. В. Божко, П. П. Шигорін.

DOI: [10.36910/6775-2313-5352-2020-17-27](https://doi.org/10.36910/6775-2313-5352-2020-17-27)

124. Kinetic Effects in Cadmium Antimonide Crystals Before and After Gamma-Irradiation // Physics and Chemistry of Solid State / Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. – Ivano-Frankivsk, 2020. – Vol. 21, № 2. – P. 266–271.

Soautor: D. A. Zakharchuk, Y. V. Koval, L. V. Yashchynskiy, O. A. Urban.

DOI: [10.15330/pcss.21.2.266-271](https://doi.org/10.15330/pcss.21.2.266-271)

**Доповіді на наукових конференціях та семінарах
1993**

125. Оптичні і фотоелектричні властивості монокристалів $Ag_xGa_xGe_{1-x}Se_2$ ($x=0,14$ і $x=0,25$) // Звітно-наукова конференція кафедр математики, математичного аналізу, фізики, хімії, 14 квіт. 1993 р. : тези доп. / Луцький держ. пед. ін-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1993. – С. 78.

Співавт.: І. Д. Олексюк, Г. Є. Давидюк, В. В. Божко, Г. П. Шаварова, М. С. Богданюк, Г. П. Горгут.

1994

126. Вольтамперні характеристики антимоніду кадмію, опромінених швидкими нейтронами // Матеріали XL наукової конференції професорсько-викладацького складу і студентів ун-ту. Серія фізична : квіт. 1994 р. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1994. – С. 15.

Співавт.: В. П. Доскоч, М. С. Богданюк, В. В. Божко, Г. Є. Давидюк.

127. Вплив радіаційних дефектів на електричні властивості $CdSb$ – монокристалів // Матеріали XL наукової конференції професорсько-викладацького складу і студентів ун-ту. Серія фізична : квіт. 1994 р. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1994. – С. 13.

Співавт.: Г. Є. Давидюк, В. В. Божко, М. С. Богданюк, В. П. Доскоч, В. О. Савош.

128. Вплив γ - і нейтронної радіації на оптичні властивості монокристалів $CdSb$ // Матеріали XL наукової конференції професорсько-викладацького складу і студентів ун-ту. Серія фізична : квіт. 1994 р. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1994. – С. 12.

Співавт.: В. В. Божко, М. С. Богданюк, В. П. Доскоч, Г. Є. Давидюк.

129. Вплив γ - радіації на оптичні властивості твердих розчинів $Ag_xGa_xGe_{1-x}Se_2$ ($0,12 \leq x \leq 0,4$) // Матеріали XL наукової конференції професорсько-викладацького складу і студентів ун-ту. Серія фізична : квіт. 1994 р. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1994. – С. 18.

Співавт.: І. Д. Олексюк, Г. Є. Давидюк, В. В. Булатецький, Г. П. Шаварова, Г. П. Горгут.

130. Електричні і оптичні властивості монокристалів $\text{Ag}_x\text{Ga}_x\text{Ge}_{1-x}\text{Se}_2$ ($0,12 < x < 0,4$) // The First International Conference on Material Science of Chalkogenide and Diamond – Structure Semiconductors, 4–6 oct. 1994 : Abstract Booklet. – Chernivtsi, 1994. – Vol. 1. – P. 69.

Співавт.: І. Д. Олексеюк, Г. Є. Давидюк, М. С. Богданюк, Г. П. Горгут, Г. П. Шаварова.

131. Оптичні властивості сполук Tl_3PbJ_5 , Tl_3PbBr_5 , Tl_3PbCl_5 // Матеріали XL наукової конференції професорсько-викладацького складу і студентів ун-ту. Серія фізична ; квіт. 1994 р. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1994. – С. 17.

Співавт.: І. Д. Олексеюк, А. М. Падалко, В. В. Булатецький, А. А. Федонюк, Г. Є. Давидюк, С. Т. Олексеюк.

132. Фотоелектричні властивості CdSb-монокристалів опромінених γ -квантами ^{60}Co і швидкими реакторними нейтронами // Матеріали XL наукової конференції професорсько-викладацького складу і студентів ун-ту. Серія фізична : квіт. 1994 р. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1994. – С. 14.

Співавт.: В. В. Божко, В. П. Доскоч, Г. Є. Давидюк, М. С. Богданюк.

1995

133. Вплив поверхні на електричні властивості монокристалів CdSb опромінених нейтронами // Матеріали XLI наукової конференції професорсько-викладацького складу і студентів Волинського державного університету. Серія Фізична : квіт. 1995 р. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: А. В. Свідзинський [та ін.]. – Луцьк, 1995. – С. 10.

Співавт.: В. П. Доскоч, П. Ф. Назарчук, В. В. Божко, Г. Є. Давидюк, М. С. Богданюк.

134. Структура спектрів поглинання монокристалів Tl_3Pb_5 (Г – Cl, Br, J) // Матеріали XLI наукової конференції професорсько-викладацького складу і студентів Волинського державного університету. Серія Фізична : квіт. 1995 р. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: А. В. Свідзинський [та ін.]. – Луцьк, 1995. – С. 7–8.

Співавт.: І. Д. Олексеюк, Г. Є. Давидюк, А. А. Федонюк, В. В. Булатецький, Р. М. Каліщук.

1997

135. Вплив пружної деформації на фоточутливість γ -опроміненого n-Ge // Sensors for Control of. Irradiation : Abstracts of IV-th NEXUSPAN Workshop, May 30-31, 1997, Odessa, Ukraine. – Odessa, 1997. – P. 22–23.

Співавт.: В. П. Доскоч, А. В. Федосов.

2000

136. Особливості впливу глибоких радіаційних центрів на провідність π -Ge при одновісній пружній деформації // Фундаментальні і прикладні проблеми сучасної фізики : матеріали II Міжнар. Смакулового симпозиуму. 6–10 верес. 2000 р. / Тернопіл. держ. техн. ун-т, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України ; редкол.: Л. Дідух [та ін.]. – Тернопіль, 2000. – С. 187.

Співавт.: А. В. Федосов, М. В. Хвищун, Л. В. Ящинський.

2002

137. Особливості п'єзоопору γ -опромінених монокристалів n-Ge та n-Si при освітленні // 1-а Українська наукова конференція з фізики напівпровідників (УНКФН-1) (з міжнародною участю), 10–14 верес. 2002 р. – Одеса, 2002. – Т. 2. – С. 87.

Співавт.: А. В. Федосов, Д. А. Захарчук, Л. В. Ящинський.

138. Особливості утворення термодонорів у кристалах n-Si<Ge> // ЄВРІКА-2002 : зб. тез. Всеукр. конф. молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики, 22–24 трав. 2002 р. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2002. – С. 15–16.

Співавт.: М. В. Хвищун, Д. А. Захарчук, А. М. Коровицький.

2003

139. Оцінка величини зміщення рівнів радіаційних дефектів у γ -опромінених Ge і Si при одновісному стиску // Актуальні проблеми фізики напівпровідників : тези доп. IV Міжнар. наук.-конф., 24–27 черв. 2003 р. – Дрогобич, 2003. – С. 184–185.

Співавт.: А. В. Федосов, Д. А. Захарчук, М. В. Хвищун, Ю. В. Коваль.

2004

140. Вплив легуючої домішки телуру на ефект перемикання в кристалах CdSb // ЕВРІКА-2004 : зб. тез. Міжнар. конф. молодих науковців з теорет. та експериментал. фізики, 19–21 трав. 2004 р. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2004. – С. 70–71.

Співавт.: Ю. Коваль, Л. Ящинський.

141. Вплив шарів росту на ВАХ монокристалів CdSb з домішкою Te // 2-а Українська наукова конференція з фізики напівпровідників (УНКФН-2) (з міжнародною участю), 20–24 верес. 2004 р., м. Чернівці – Вижниця. – Чернівці, 2004. – Т. 2. – С. 278–279.

Співавт.: А. В. Федосов, Л. В. Ящинський, Ю. В. Коваль, А. Йонік.

142. Температурні залежності положення рівня Фермі в германії при наявності глибоких енергетичних рівнів // 10-ий Міжнар. семінар з фізики та хімії твердого тіла, 6–9 черв. 2004 р. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2004. – С. 84.

Співавт.: Д. Захарчук, А. Федосов.

143. The Radiation Stimulated Rise of Mobility of Current Carriers in the Cadmium Antimonid Monocrystals, Alloyed by Indium // Радіофізика та НВЧ електроніка : програма конф. та зб. анотацій IV Харків. конф. молодих науковців, 15–17 груд. 2004 р. / Ін-т радіофізики та електроніки ім. Усикова НАН України. – Харків, 2004. – С. 71–72.

Soautor: Yu. V. Koval, D. A. Zakharchuk, M. V. Khwishchun.

2005

144. Дослідження впливу інтенсивності освітлення на кінетичні ефекти в монокристалах антимоніду кадмію // Фізика в Україні : тези доп. Всеукр. з'їзд, 3–6 жовт. 2005 р. – Одеса, 2005. – С. 185.

Співавт.: А. В. Федосов, Ю. В. Коваль, Л. В. Ящинський, Д. А. Захарчук.

145. Подвижность носителей заряда в γ -облученных монокристаллах антимонида кадмия, легированных индием // Радиационная физика

твёрдого тела : труды XV Междунар. совещания, 4–9 июля 2005 г., г. Севастополь, Украина / ред. Г. Г. Бондаренко. – М., 2005. – С. 108–112.
Соавт.: А. В. Федосов, Ю. В. Коваль, Л. В. Ящинский, В. И. Хиврыч.

2006

146. Влияние γ -облучения на пьезосопротивление и подвижность носителей заряда в n-Ge при наличии слоистых периодических неоднородностей // Радиационная физика твёрдого тела : труды XVI Междунар. совещания, 3–8 июля 2006 г., г. Севастополь / ред. Г. Г. Бондаренко – М., 2006. – С. 186–191.

Соавт.: А. В. Федосов, Д. А. Захарчук, Р. Н. Семенченко, Ю. В. Коваль.

147. Температурная зависимость уровня Ферми в монокристаллах антимида кадмия при наличии глубокого энергетического уровня $E_C - 0,3$ эВ // Радиационная физика твёрдого тела : труды XVI Междунар. совещания, 3–8 июля 2006 г., г. Севастополь / ред. Г. Г. Бондаренко – М., 2006. – С. 183–185.

Соавт.: А. В. Федосов, Ю. В. Коваль, Д. А. Захарчук, Л. В. Ящинський.

2007

148. Визначення глибини залягання енергетичних рівнів в забороненій зоні напівпровідників за даними п'єзоопору // III Українська наукова конференція з фізики напівпровідників (УНКФН-3), 17–22 черв. 2007 р. – Одеса, 2007. – С. 209.

Співавт.: А. В. Федосов, Ю. В. Коваль, Л. В. Ящинський.

149. Вплив технологічних та радіаційних дефектів на тензоефекти в кремнії // III Українська наукова конференція з фізики напівпровідників (УНКФН-3), 17–22 черв. 2007 р. – Одеса, 2007. – С. 440.

Співавт.: А. Федосов, Д. Захарчук, Р. Семенченко, М. Хвищун, С. Луньов, С. Місюк.

150. Дослідження ефекту п'єзоопору в багатодолинних напівпровідниках з глибокими енергетичними рівнями // ІЕФ-2007 : програма та тези доп. конф. молодих вчених та аспірантів, 14–19 трав. 2007 р. / Ін-т електронної фізики НАН України. – Ужгород, 2007. – С. 137.

Співавт.: Ю. В. Коваль, Д. А. Захарчук, М. В. Хвищун, С. В. Луньов.

151. Пьезосопротивление в монокристаллах антимонида кадмия, легированных теллуром, до и после γ -облучения // Радиационная физика твердого тела : труды XVII Междунар. совещания, 9–14 июля 2007 г., г. Севастополь / ред. Г. Г. Бондаренко – М., 2007. – С. 228–231.

Соавт.: А. В. Федосов, Ю. В. Коваль, Л. В. Ящинский, Д. А. Захарчук.

2008

152. Визначення константи зсуву деформаційного потенціалу в монокристалах n-Si при наявності радіаційних дефектів // Радіофізика та електроніка, біофізика : програма конф. та зб. анотацій доп. VIII Харків. конф. молодих науковців, 25–27 листоп. 2008 р. – Харків, 2008. – С. 82.

Співавт.: А. В. Федосов, С. В. Луньов, Д. А. Захарчук, Л. І. Панасюк.

153. Тензоэффекты в монокристаллах кремния при наличии радиационных дефектов // Радиационная физика твердого тела : труды XVIII Междунар. совещания, 7–12 июля 2008 г., г. Севастополь / ред. Г. Г. Бондаренко. – М., 2008. – С. 212–217.

Соавт.: А. В. Федосов, Д. А. Захарчук, Ю. В. Коваль, С. В. Лунёв.

154. Influence of Illumination on Anisotropy of Properties in Monocrystals CdSb(Te) // Relaxed, Nonlinear and Acoustic Optical Processes; Materials – Growth and Optical Properties (RNAOPM'2008) : Proc. of 4-th International Workshop, 1–5 June 2008, Lutsk – Shatsk Lakes. – Lutsk, 2008. – P. 76–79.

Soautor: A. V. Fedosov, Yu. V. Koval, L. V. Jashchinskij.

2009

155. Визначення константи зсуву деформаційного потенціалу в кремнії і германії при наявності радіаційних дефектів // Всеукраїнський семінар із теоретичної та математичної фізики (ТМФ'2009), до 80-річчя професора А. В. Свідзинського : матеріали конф., 27 лют.–1 берез. 2009 р. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – С. 97–99.

Співавт.: А. В. Федосов, С. В. Луньов, Д. А. Захарчук, Л. І. Панасюк.

156. Влияние одноосной упругой деформации на подвижность носителей тока в монокристаллах n-Si при наличии глубоких энергетических

уровней // Взаимодействие излучений с твердым телом (ВИТТ-2009) : материалы VIII Междунар. конф., 23–25 сент. 2009 г., г. Минск / редкол.: В. М. Анищик (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2009. – С. 357–359.

Соавт.: А. В. Федосов, С. В. Лунёв.

157. Влияние одноосной упругой деформации на положение глубоких энергетических уровней в кристаллах n-Si(Ge) // Радиационная физика твердого тела : труды XIX Междунар. совещания, 31 авг. – 5 сент. 2009 г., г. Севастополь / ред. Г. Г. Бондаренко. – М., 2009. – С. 256–260.

Соавт.: А. В. Федосов, С. В. Лунёв, С. Я. Мисюк, А. М. Коровицкий.

158. Вплив одноосної пружної деформації на положення глибоких енергетичних рівнів у кристалах n-Ge<Au> // IV Українська наукова конференція з фізики напівпровідників (УНКФН-4), 15–19 верес. 2009 р., м. Запоріжжя / Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – Т. 1. – С. 88.

Співавт.: А. В. Федосов, С. В. Лунёв, Д. А. Захарчук, Л. І. Панасюк.

159. Вплив освітлення на явища переносу в монокристалах антимоніду кадмію // IV Українська наукова конференція з фізики напівпровідників (УНКФН-4), 15–19 верес. 2009 р., м. Запоріжжя / Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – Т. 1. – С. 87–88.

Співавт.: А. В. Федосов, Ю. В. Коваль, Л. В. Ящинський.

160. Определение сдвиговой константы деформационного потенциала в германии и кремнии при наличии радиационных дефектов // Радиационная физика твердого тела : труды XIX Междунар. совещания, 31 авг. – 5 сент. 2009 г., г. Севастополь / ред. Г. Г. Бондаренко. – М., 2009. – С. 249–255.

Соавт.: А. В. Федосов, С. В. Лунёв, Д. А. Захарчук.

161. Тензорезистивний ефект в монокристалах n-Si<Ge> при наявності радіаційних дефектів // IV Українська наукова конференція з фізики напівпровідників (УНКФН-4), 15–19 верес. 2009 р. / Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – Т. 1. – С. 220 ; Т. 2. – С. 123–124.

Співавт.: А. В. Федосов, С. В. Лунёв, С. Я. Мисюк, А. М. Коровицкий.

162. Визначення константи деформаційного потенціалу Ξ_d в n-Si // Релаксаційні, нелінійні й акустооптичні процеси та матеріали (РНАОПМ'2010) : матеріали V Міжнар. наук. конф., 1–5 черв. 2010 р., м. Луцьк – Шацькі озера / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – С. 185–188.

Співавт.: А. В. Федосов, С. В. Луньов.

163. Влияние радиационных дефектов на пьезосопротивление n-Si // Радиационная физика твердого тела : труды XX Междунар. совещания, 5–10 июля 2010 г., г. Севастополь / ред. Г. Г. Бондаренко. – М., 2010. – Т. 1. – С. 291–298.

Соавт.: А. В. Федосов, С. В. Лунёв, Д. А. Захарчук.

164. Вплив глибоких енергетичних рівнів на п'єзоопір n-Si // Актуальні проблеми теоретичної та експериментальної фізики АПТЕФ 2010 : матеріали наук. семінару, 27–28 січ. 2010 р. / Терноп. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2010. – С. 42–43.

Співавт.: А. В. Федосов, С. В. Луньов.

165. Вплив концентрації домішок на п'єзоопір n-Ge // Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи : матеріали Всеукр. конф. молодих вчених, 20–21 жовт. 2010 р. / Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2010. – С. 162–163.

Співавт.: С. В. Шинкарук.

166. Вплив одновісної пружної деформації на положення та ступінь заповнення глибокого енергетичного рівня $E_C - 0,17$ eV в n-Si // Актуальні проблеми фізики напівпровідників : тези доп. VII Міжнар. шк.-конф., 28 верес. – 1 жовт. 2010 р. / Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка – Дрогобич, 2010. – С. 185.

Співавт.: С. В. Луньов, Д. А. Захарчук, Л. В. Ящинський.

167. Кінетичні ефекти в монокристалах антимоніду кадмію в полях ефективного зовнішнього впливу // Фізика і хімія твердого тіла: стан,

досягнення і перспективи : матеріали Всеукр. конф. молодих вчених, 20–21 жовт. 2010 р. / Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2010. – С. 287–289.

Співавт.: Л. В. Ящинський, А. В. Федосов, Ю. В. Коваль, Л. В. Коваль.

168. Особенности температурных зависимостей уровня Ферми в монокристаллах антимонида кадмия, легированных теллуром, до и после облучения // Радиационная физика твердого тела : труды XX Междунар. совещания, 5–10 июля 2010 г., г. Севастополь / ред. Г. Г. Бондаренко. – М., 2010. – Т. 1. – С. 286–290.

Соавт.: А. В. Федосов, Ю. В. Коваль, Д. А. Захарчук, Л. В. Ящинский.

169. Determination of Deformation Potential Constant Ξ_d in n-Ge // Квантовая электроника : материалы VIII Междунар. науч.-техн. конф., 22–25 нояб. 2010 г. – Минск, 2010. – С. 54.

Soauthor: A. V. Fedosov, S. V. Luniov.

170. Temperature Dependencies of Fermi Level in Single Crystals of Cadmium Antimonide with Deep Energy Levels // Relaxed, Nonlinear and Acoustic Optical Processes; Materials – Growth and Optical Properties (RNAOPM'2010) : Proc. of V-th International Workshop, June 1–5, 2010, Lutsk – Shatsk Lakes / Lesya Ukrayinka Volyn State University. – Lutsk, 2010. – P. 142–144.

Soauthor: A. V. Fedosov, Yu. V. Koval, L. V. Yashchynskyy.

2011

171. Вплив опромінення на фізичні властивості монокристалів антимоніду кадмію // V Українська наукова конференція з фізики напівпровідників, 9–15 жовт. 2011 р. / І-нт електронної фізики НАН України. – Ужгород, 2011. – Т. 2. – С. 256–257.

Співавт.: Л. В. Ящинський, Ю. В. Коваль, Д. А. Захарчук.

172. Міждолинне розсіювання електронів у n-Si в області температур 300–450 К // V Українська наукова конференція з фізики напівпровідників, 9–15 жовт. 2011 р. / І-нт електронної фізики НАН України. – Ужгород, 2011. – Т. 2. – С. 72.

Співавт.: Л. І. Панасюк, В. М. Єрмаков, В. В. Коломоєць, П. Ф. Назарчук.

173. Особенности проводимости γ -облученного антимонида кадмия // Радиационная физика твердого тела : труды XXI Междунар. конф., 22–27 авг. 2011 г., г. Севастополь / ред. Г. Г. Бондаренко. – М., 2011. – Т. 2. – С. 537–545.

Співавт.: Л. В. Ящинский, Ю. В. Коваль, Д. А. Захарчук, Л. В. Коваль, Г. Л. Мирончук.

174. Расчет константы деформационного потенциала Ξ_d в γ -облученном p-Si // Радиационная физика твердого тела : труды XXI Междунар. конф., 22–27 авг. 2011 г., г. Севастополь / ред. Г. Г. Бондаренко. – М., 2011. – Т. 1. – С. 268–273.

Співавт.: С. В. Лунев, Д. А. Захарчук, Ю. В. Коваль, Л. В. Ящинский.

175. Тензорезистивні ефекти у сильно деформованих слабоізоляторних кристалах p-Si(B) при $T=4,2$ К // V Українська наукова конференція з фізики напівпровідників, 9–15 жовт. 2011 р. / І-нт електронної фізики НАН України. – Ужгород, 2011. – Т. 2. – С. 251.

Співавт.: В. М. Єрмаков, В. В. Коломоєць, П. Ф. Назарчук, Л. І. Панасюк.

2012

176. Вплив домішок Te та In на дефектність монокристалів антимоніду кадмію // Релаксаційні, нелінійні й акустооптичні процеси та матеріали : матеріали VI міжнар. наук. конф., 25–29 трав. 2012 р. / [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. – Луцьк, 2012. – С. 31–33. – Бібліогр.: 7 назв.

Співавт.: М. С. Богданюк, Л. В. Ящинський, Д. А. Захарчук, Ю. В. Коваль.

177. Дослідження неоднорідностей в монокристалах антимоніду кадмію // Актуальні проблеми прикладної фізики АППФ-2012 : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 24–28 верес. 2012 р., г. Севастополь / за заг. ред. М. О. Лазаренкова / Севастопол. нац. ун-т ядерної енергії та промисловості. – Севастополь, 2012. – С. 106–107.

Співавт.: Ю. В. Коваль, Л. В. Ящинський, Д. А. Захарчук.

178. Особенности пьезосопротивления γ -облученных монокристаллов p-Ge и p-Si при подсветке // Радиационная физика твердого тела : труды XXII Междунар. конф., 9–14 июля 2012 г., г. Севастополь / ред.

Г. Г. Бондаренко. – М., 2012. – С. 198–202.

Співавт.: Д. А. Захарчук, Л. В. Ящинський, Ю. В. Коваль, Л. В. Коваль, Г. Л. Мирончук.

179. Положення рівня Фермі в забороненій зоні антимоніду кадмію при наявності технологічних та радіаційних дефектів // Релаксаційні, нелінійні й акустооптичні процеси та матеріали : матеріали VI міжнар. наук. конф., 25–29 трав. 2012 р. / [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. – Луцьк, 2012. – С. 57–58. – Бібліогр.: 4 назви.

Співавт.: Д. А. Захарчук, Ю. В. Коваль, П. І. Котюх.

180. Investigations Inhomogeneities in Cadmium Antimonide Monocrystals // Relaxed, Nonlinear and Acoustic Optical Processes; Materials – Growth and Optical Properties (RNAOPM'2012) : Proc. of VI-th International Workshop, May 25–29, 2012, Lutsk – Shatsk Lakes. – Lutsk, 2012. – P. 241–243.

Soautor: Yu. V. Koval, L. V. Yashchynskyu, D. A. Zakharchuk.

181. Monocrystalline Silicon, Whiskers and Nanowires as Advanced Technologies of Uniaxial Strain Sensor // Clusters and Nanostructured Materials (CNM-3) : Program & Materials III Inter. Meeting, Oct. 14–17, 2012, Uzhgorod. – Uzhgorod, 2012. – P. 200.

Soautor: L. Panasyuk, A. Bozhko, V. Kolomoets, V. Ermakov, B. Orasgulyev, L. Yashchynskiy.

2013

182. Вплив ізовалентної домішки германію на неоднорідність питомого опору в кристалах кремнію // Збірник тез VI Української наукової конференції з фізики напівпровідників (УНКФН–6), 30 верес. – 4 жовт. 2013 р. / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2013. – С. 272–273.

Співавт.: Д. А. Захарчук, А. М. Коровицький, Ю. В. Коваль, Л. В. Ящинський.

183. Вплив температури на люмінесцентні властивості стекол системи $\text{Ag}_{0.05}\text{Ga}_{0.05}\text{Ge}_{0.95}\text{S}_2\text{-Er}_2\text{S}_3$ // Електроніка та інформаційні технології : програма і матеріали V наук.-практ. конф., 29 серп. – 1 верес. 2013 р.

м. Львів – Чинадієво – Мукачево / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2013. – С. 117.

Співавт.: В. В. Галян, А. Г. Кевшин, М. В. Шевчук.

184. Енергетичні стани технологічних термодонорів у нейтронно-легованому кремнію // Збірник тез VI Української наукової конференції з фізики напівпровідників (УНКФН–6), 30 верес. – 4 жовт. 2013 р. / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2013. – С. 544–545.

Співавт.: Л. І. Панасюк, В. В. Коломоєць, В. М. Єрмаков, В. І. Хіврич.

185. Кінетичні ефекти в монокристалах антимоніду кадмію у полях ефективного зовнішнього впливу // Збірник тез VI Української наукової конференції з фізики напівпровідників (УНКФН–6), 30 верес. – 4 жовт. 2013 р. / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2013. – С. 278–279.

Співавт.: Ю. В. Коваль, Л. В. Ящинський, Д. А. Захарчук.

186. Передумови розвитку конкурентоспроможних університетів // Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки : зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф., 4–5 жовт. 2013 р. / Волин. облдержадмін., Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [ред.: В. Є. Сикора та ін.]. – Луцьк, 2013. – С. 31–32.

Співавт.: В. В. Божко, В. Кажукаускас.

187. Технологические термодоноры в трансмутационно-легированном γ -облученном кремнии // Взаимодействие излучений с твердым телом : материалы X Междунар. конф., 24–27 сентяб. 2013 г. / Белорус. гос. ун-т, Нац. акад. наук Беларуси ; редкол.: В. М. Анишик (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2013. – С. 137–139.

Соавт.: Л. И. Панасюк, В. В. Коломоєць, В. Н. Єрмаков, П. П. Трохимчук, Б. Б. Сусь.

2014

188. Взаємодія компонентів на перерізі $\text{AgSbSe}_2 - \text{PbSe}$ // XIX Українська конференція з неорганічної хімії (за участю закордонних учених), 7–11

верес. 2014 р. / НАН України, Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Одеса, 2014. – С. 213.

Співавт.: О. Ф. Змій, Т. А. Остап'юк, Н. А. Божко, О. В. Новосад, І. Д. Алексеюк, П. В. Торченко.

189. Використання методу вимірювання поздовжнього п'єзоопору для визначення модуля пружності в монокристалах n-Ge // Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів, 24–26 жовт. 2014 р. / Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2014. – С. 228–230.

Співавт.: М. В. Хвищун.

190. Вплив дози гамма-опромінення на структурні порушення у монокристалах антимоніду кадмію // Релаксаційні, нелінійні й акустооптичні процеси та матеріали : матеріали VII міжнар. наук. конф., 8–12 черв. 2014 р., м. Луцьк – Шацькі озера / [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. – Луцьк, 2014. – С. 144–146. – Бібліогр.: 2 назви.

Співавт.: Д. А. Захарчук, Ю. В. Коваль, Л. В. Ящинський.

191. Вплив радіаційних порушень на електричні властивості в сурм'янистому кадмію // Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів, 24–26 жовт. 2014 р. / Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2014. – С. 24–26.

Співавт.: В. І. Василишина, Д. А. Захарчук, Л. В. Ящинський.

192. Електричні властивості твердих розчинів PbSe–AgSbSe₂ // Всеукраїнський семінар з теоретичної та математичної фізики до 85-річчя професора А. В. Свідзинського : матеріали, 27 лют. – 1 берез. 2014 р. / [вид. ком.: П. П. Трохимчук та ін.]. – Луцьк, 2014. – С. 97–99. – Бібліогр.: с. 98–99.

Співавт.: Н. А. Божко, О. В. Новосад, О. Яблонський.

193. П'єзоопір n-Ge в області власної провідності // Релаксаційні, нелінійні й акустооптичні процеси та матеріали (РНАОПМ'2014) : матеріали VII міжнар. наук. конф., 8–12 черв. 2014 р., м. Луцьк – Шацькі озера /

[Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. – Луцьк, 2014. – С. 256–258. –
Бібліогр.: 6 назв.

Співавт.: М. В. Хвищун, О. Росоловська, М. Мельник.

2015

194. Взаємодія компонентів AgSbSe_2 і PbSe та електричні і термоелектричні властивості твердих розчинів на їх основі // Актуальні проблеми фундаментальних наук АПФН'2015 : матеріали I Міжнар. наук, конф., присвяч. 75-річчю проф. І. Д. Олексеюка, 31 трав. – 3 черв. 2015 р., м. Луцьк – озеро Світязь. – Луцьк, 2015. – С. 84–87.

Співавт.: Н. А. Божко, О. В. Новосад, І. Д. Олексеюк, О. Ф. Змій, Т. А. Остап'юк.

195. Взаимодействие компонентов AgSbSe_2 и PbSe , термоэлектрические свойства монокристаллов на их основе // Квантовая электроника : материалы X Междунар. науч.-техн. конф., 9–13 нояб. 2015 г. / Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2015. – С. 46.

Соавт.: Н. А. Божко, А. В. Новосад, А. П. Третьяк, Н. В. Иллюшко.

196. Методи дослідження поздовжнього і поперечного п'єзоопору в кристалах кремнію // Актуальні проблеми фундаментальних наук АПФН'2015 : матеріали I Міжнар. наук, конф., присвяч. 75-річчю проф. І. Д. Олексеюка, 31 трав. – 3 черв. 2015 р., м. Луцьк – озеро Світязь. – Луцьк, 2015. – С. 201–202.

Співавт.: М. В. Хвищун, Л. В. Ящинський.

197. Розрахунок величини зміщення глибоких енергетичних рівнів у γ -опромінених монокристалах n-Ge та n-Si // Актуальні проблеми фундаментальних наук АПФН'2015 : матеріали I Міжнар. наук, конф., присвяч. 75-річчю проф. І. Д. Олексеюка, 31 трав. – 3 черв. 2015 р., м. Луцьк – озеро Світязь. – Луцьк, 2015. – С. 118–119.

Співавт.: Д. А. Захарчук, Л. В. Ящинський, Ю. В. Коваль, М. В. Хвищун.

2016

198. Дослідження температурної залежності електропровідності монокристалів $\text{AgGaGe}_3\text{Se}_8$ // Фізика і хімія твердого тіла: стан,

досягнення і перспективи : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів, 28–29 жовт. 2016 р. / Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2016. – С. 146–148.

Співавт.: О. К. Столярчук, О. Кльоц, Д. Мирончук.

199. Електронна гармата трансмісійного електронного мікроскопа // Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів, 28–29 жовт. 2016 р. / Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2016. – С. 128–129.

Співавт.: В. В. Мороз.

200. Особливості структурних неоднорідностей в легованих монокристалах антимоніду кадмію // VII Українська наукова конференція з фізики напівпровідників (УНКФН-7), 26–30 верес. 2016 р., м. Дніпро. – Кременчук, 2016. – С. 364–365.

Співавт.: Ю. В. Коваль, Д. А. Захарчук, Л. В. Ящинський, Л. І. Панасюк.

201. Розрахунок глибини залягання енергетичних рівнів у монокристалах антимоніду кадмію за даними п'єзоопору // Релаксаційні, нелінійні й акустооптичні процеси та матеріали (РНАОПМ'2016) : матеріали VIII Міжнар. наук. конф., 1–4 черв. 2016 р., м. Луцьк – Світязь. – Луцьк, 2016. – С. 223–225.

Співавт.: Ю. В. Коваль, Д. А. Захарчук, Л. В. Ящинський, Л. І. Панасюк.

202. Температурна залежність електропровідності монокристалів $PbSe-AgSbSe_2$ // Релаксаційні, нелінійні й акустооптичні процеси та матеріали (РНАОПМ'2016) : матеріали VIII Міжнар. наук. конф., 1–4 черв. 2016 р., м. Луцьк – Світязь. – Луцьк, 2016. – С. 80–81.

Співавт.: Н. А. Божко, О. В. Новосад, О. Ф. Змій, Т. А. Остап'юк, А. О. Рижук, В. В. Федорук.

203. Feature of Kinetic Effects in Tellurium-Alloyed Cadmium Antimonide Single Crystals // Topical Problems of Semiconductor Physics : IX Inter. Conf., May 16–20, 2016, Truskavets : Abstract Book. – Stryi, 2016. – P. 57–58.

Soautor: Yu. V. Koval, D. A. Zakharchuk, L. V. Yashchinskiy.

204. Optical Absorption Spectra and Photoluminescence of $\text{Ag}_{1,6}\text{Ga}_{1,6}\text{Ge}_{31,2}\text{S}_{61,6-x}\text{Se}_x$ Glassy Alloys // Topical Problems of Semiconductor Physics : IX Inter. Conf., May 16–20, 2016, Truskavets : Abstract Book. – Stryi, 2016. – P. 47.

Soautor: I. A. Ivashchenko, V. V. Halyan, A. H. Kevshyn, M. V. Shevchuk.

2017

205. Оцінка гомогенності розподілу часток у карбону в полімерах з використанням морфометричної моделі // Математика. Інформаційні технології. Освіта : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., 5–7 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 98–104.

Співавт.: В. В. Мороз, О. В. Замуруєва, А. М. Коровицький.

206. Трансмисійний електронний мікроскоп // Актуальні проблеми фундаментальних наук (АПФН'2017) : матеріали II Міжнар. наук. конф., 1–6 черв. 2017 р., м. Луцьк – озеро Світязь. – Луцьк, 2017. – С. 30–32.

Співавт.: Т. Войтович, В. Мороз.

207. Энергетическая зависимость коэффициента поглощения света $\text{A}^{\text{IV}}\text{B}^{\text{III}}\text{C}_2^{\text{VI}}$ // Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп'ютерних систем (MEICS-2017) : тези доп. II Всеукр. наук.-практ. конф., 22–24 листоп. 2017 р., м. Дніпро. – Дніпро ; Кременчук, 2017. – С. 316.

Соавт.: Н. Скипальский, В. Наход.

2018

208. Вплив поверхні на провідність напівпровідника // Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень : матеріали XII Міжнарод. наук.-практ. конф. аспірантів і студентів, 15–16 трав. 2018 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Наук. т-во аспірантів і студентів. – Луцьк, 2018. – С. 974–976.

Співавт.: Т. В. Войтович.

209. Гетеропереходи в електронній техніці // Relaxed, Nonlinear, Acoustic Optical Processes and Materials (RNAOPM'2018) : Proc. Conf. IX Inter. Sci. Conf.; Art-Science Technology : The first Volyn-Pomerania Interdiscipl.

Summer School (VPISSAST'2018), June 01–05, 2018, Lutsk–Lake «Svityaz'».
– Lutsk, 2018. – P. 56.

Співавт.: Я. Данилик, Т. В. Войтович.

210. Дослідження фізичних властивостей мінералу галіт // Relaxed, Nonlinear, Acoustic Optical Processes and Materials (RNAOPM'2018) : Proc. Conf. IX Inter. Sci. Conf.; Art-Science Technology : The first Volyn-Pomerania Interdiscipl. Summer School (VPISSAST'2018), June 01–05, 2018, Lutsk–Lake «Svityaz'». – Lutsk, 2018. – P. 135.

Співавт.: Ю. П. Шипелик.

211. Залежність типу провідності сполук $A^I B^{III} C_2^{VI}$ від катіонного заміщення // Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів, 25–26 жовт. 2018 р. / Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2018. – С. 18–19.

Співавт.: О. В. Замуруєва, А. М. Коровицький, В. В. Мороз.

212. Монокристали $Cd_{0,96}Zn_{0,04}Te$ як матеріал для створення фотоелектроперетворювачів // Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів, 25–26 жовт. 2018 р. / Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2018. – С. 107–109.

Співавт.: О. В. Новосад, В. В. Божко.

213. Напівпровідники в світлодіодних приладах // Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень : матеріали XII Міжнарод. наук.-практ. конф. аспірантів і студентів, 15–16 трав. 2018 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Наук. т-во аспірантів і студентів. – Луцьк, 2018. – С. 998–1000.

Співавт.: Я. В. Стасюк.

214. Підготовка вчителів фізики у закладах вищої освіти відповідно до європейської практики // Неперервна освіта в модусах минулого, теперішнього, майбутнього : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 24–26 трав. 2018 р. – Луцьк, 2018. – С. 21–22.

215. Спектр поглинання та фотолюмінесценція монокристалу $(\text{Ga}_{69,75}\text{La}_{29,75}\text{Er}_{0,5})_2\text{S}_{300}$ // Relaxed, Nonlinear, Acoustic Optical Processes and Materials (RNAOPM'2018) : Proc. Conf. IX Inter. Sci. Conf.; Art-Science Technology : The first Volyn-Pomerania Interdiscipl. Summer School (VPISSAST'2018), June 01–05, 2018, Lutsk–Lake «Svityaz'». – Lutsk, 2018. – P. 55.

Співавт.: В. В. Галян, І. А. Іващенко, А. Г. Кевшин, І. Д. Олексеюк, П. В. Тищенко, А. П. Третяк, М. В. Шевчук.

2019

216. Аналіз структурних рішень оптичних сенсорів // Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень : матеріали XIII Міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів, 14–15 трав. 2019 р. – Луцьк, 2019. – Ч. 2. – С. 847–849.

Співавт.: В. В. Козак, А. А. Дмитрук.

217. Зміна провідності у кристалах антимоніду кадмію після гамма-опромінення // Actual Problems of Fundamental Science (APFS'2019) : Proc. III-nd Inter. Conf., June 01–05, 2019, Lutsk – Svityaz'. – Lutsk, 2019. – P. 131.

Співавт.: Ю. В. Коваль, Д. А. Захарчук, Л. В. Ящинський.

218. Прямі та непрямі оптичні переходи у кристалічних сполуках $\text{TlInX}_2\text{--D}^{\text{IV}}\text{X}_2$ (D^{IV} – Si, Ge, Sn; X – S, Se) // Actual Problems of Fundamental Science (APFS'2019) : Proc. III-nd Inter. Conf., June 01–05 2019, Lutsk – Svityaz'. – Lutsk, 2019. – P. 130.

Співавт.: С. П. Данильчук, О. В. Замуруєва, В. Є. Сахнюк, Д. А. Захарчук.

219. Composition Dependence of the Direct and Indirect Bandgap for $\text{TlInX}_2\text{--D}^{\text{IV}}\text{X}_2$ (D^{IV} – Si, Ge, Sn; X – S, Se) // XVII International Conference Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (ICPTTFN-XVII), May 20–25, 2019, Ivano-Frankivsk : Abstract book / Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. – Ivano-Frankivsk, 2019. – P. 305.

Soautor: S. P. Danylchuk, V. E. Sakhnyuk, D. A. Zakharchuk.

220. Influence of Gamma-Irradiation on Structural Disturbances in Cadmium Antimonide Crystals // XVII International Conference Physics and Technology

of Thin Films and Nanosystems (ICPTTFN-XVII), May 20-25, 2019, Ivano-Frankivsk : Abstract book / Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. – Ivano-Frankivsk, 2019. – P. 307.

Soautor: Yu. V. Koval, D. A. Zakharchuk, L. V. Yashchynskiy.

221. Low-Temperature Plasticity of Uniaxially Deformed Silicon and Germanium Crystals // XVII International Conference Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (ICPTTFN-XVII), May 20-25, 2019, Ivano-Frankivsk : Abstract book / Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. – Ivano-Frankivsk, 2019. – P. 322.

Soautor: L. I. Panasjuk, Yu. V. Koval, L. V. Yashchynskyy, D. A. Zakharchuk, S. Ya. Misjuk.

222. Resonant Tunnelling Through Graphene-Based Double-Barrier Structure // XVII International Conference Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (ICPTTFN-XVII), May 20-25, 2019, Ivano-Frankivsk : Abstract book / Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. – Ivano-Frankivsk, 2019. – P. 223.

Soautor: V. E. Sakhnyuk, O. V. Zamurujeva, O. V. Dmytruk.

2020

223. Визначення потенціалів іонізації і збудження газів методом електронної спектроскопії // Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів, 16–17 жовт. 2020 р. / Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2020. – С. 96–97.

Співавт.: Ю. П. Шипелик, Д. А. Захарчук.

224. Вплив наявності шарових неоднорідностей на надійність визначення константи деформаційного потенціалу зсуву в γ -опроміненому n-Si // Relaxed, Nonlinear, Acoustic Optical Processes and Materials (RNAOPM'2020) : Proc. X Inter. Sci. Conf., June 25–29, 2020, Lutsk–Lake «Svityaz'». – Lutsk, 2020. – P. 33–35.

Співавт.: Л. В. Ящинський, Д. А. Захарчук, Ю. В. Коваль, Л. І. Панасюк.

225. Вплив γ -опромінення на електричні властивості CdSb // Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів, 16–17 жовт. 2020 р. / Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2020. – С. 128–131.

Співавт.: Д. А. Захарчук, Ю. В. Коваль, Л. В. Ящинський, Р. М. Кужель.

226. Наука та розвиток сонячної енергетики // Приладобудування та метрологія: сучасні проблеми, тенденції розвитку : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., 29–30 жовт. 2020 р. / Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2020. – С. 62–64.

Співавт.: Л. І. Никируй, О. В. Замуруєва, В. С. Федосов, В. Є. Сахнюк.

227. Наукові дослідження та розвиток світової відновлювальної енергетики // Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів, 16–17 жовт. 2020 р. / Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2020. – С. 75–78.

Співавт.: Л. І. Никируй, О. В. Замуруєва, В. С. Федосов, Г. П. Хмарук.

228. Особливості ефекту п'єзоопору в монокристалах антимоніду кадмію до та після γ -опромінення // Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів, 16–17 жовт. 2020 р. / Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2020. – С. 66–67.

Співавт.: Ю. В. Коваль, Д. А. Захарчук, Л. В. Ящинський, Л. І. Панасюк, В. М. Євсюк.

229. Стан наукових досліджень та розвиток відновлюваної енергетики в Україні // Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів, 16–17 жовт. 2020 р. / Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2020. – С. 79–81.

Співавт.: Л. І. Никируй, О. В. Замуруєва, В. С. Федосов, Д. А. Захарчук.

230. Фотонні пристрої на основі кристалічних сполук $\text{TlInX}_2\text{-D}^{\text{IV}}\text{X}_2$ (D^{IV} – Si, Ge, Sn; X – S, Se) // Приладобудування та метрологія: сучасні проблеми, тенденції розвитку : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., 29–30 жовт. 2020 р. / Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2020. – С. 21–23.

Співавт.: С. П. Данильчук, О. В. Замуруєва, В. Є. Сахнюк, Д. А. Захарчук.

Депонована праця

231. Оптические и фотоэлектрические свойства монокристаллов $Ag_xGa_xGe_{1-x}Se_2$ ($x=0,12-0,25$) / Луцкий гос. пед. ин-т. – Луцк, 1993. – 11 с. – Деп. в ДНТБ України 04.08.93 р., № 1660. – Ук. 93.

Соавт.: И. Д. Алексеюк, Г. Е. Давидюк, В. В. Божко, Н. С. Богданюк, А. П. Шаварова, Г. П. Горгут.

III. ПЕРЕЛІК АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ ЗАХИЩЕНИХ ПІД НАУКОВИМ КЕРІВНИЦТВОМ С. А. ФЕДОСОВА

1. Луньов С. В. Тензоефекти в багатодолинних напівпровідниках (n-Ge, n-Si) : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / С. В. Луньов. – Луцьк, 2011. – 20 с.

IV. ПЕРЕЛІК АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ, ПРИ ЗАХИСТІ ЯКИХ С. А. ФЕДОСОВ ВИСТУПАВ ОФІЦІЙНИМ ОПОНЕНТОМ

1. Дзумедзей Р. О. Розсіювання носіїв заряду у тонких полікристалічних плівках та пресованих матеріалах на основі телуридів свинцю та олова : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.18 / Дзумедзей Р. О. – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с.
2. Оленич І. Б. Нерівноважні електронні процеси у наносистемах на основі кремнію : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Оленич І. Б. . – Львів, 2020. – 40 с.
3. Шпортюк К. В. Фазозмінні халькогенідні сполуки та дифосфіди: вплив структури та складу на оптичні властивості в ІЧ діапазоні : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Шпортюк К. В. – Київ, 2020. – 33 с.

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК НАЗВ ПРАЦЬ

- Актуальні дослідження в області медичної фізики: виклики для України 117
- Аналіз структурних рішень оптичних сенсорів 216
- Анізотропія тензорезистивних ефектів у сильно легованих кристалах p-Si(B) в області σ_2 -провідності 103
- Асистентська практика 29
- Взаємодія компонентів AgSbSe₂ і PbSe й термоелектричні властивості твердих розчинів на їх основі 104
- Взаємодія компонентів AgSbSe₂ і PbSe та електричні і термоелектричні властивості твердих розчинів на їх основі 194
- Взаємодія компонентів на перерізі AgSbSe₂ – PbSe 188
- Взаимодействие компонентов AgSbSe₂ и PbSe, термоэлектрические свойства монокристаллов на их основе 195
- Визначення глибини залягання глибоких рівнів у n-Si методом п'єзоопору 74
- Визначення глибини залягання енергетичних рівнів в забороненій зоні напівпровідників за даними п'єзоопору 148
- Визначення глибини залягання енергетичних рівнів у забороненій зоні напівпровідників на основі досліджень ефекту п'єзоопору 75
- Визначення зміни глибини залягання електрично активного рівня у γ -опроміненому n-Si при одновісній пружній деформації 66
- Визначення констант зсуву деформаційного потенціалу в γ -опроміненому германії та кремнії 80
- Визначення константи деформаційного потенціалу [I]d в n-Ge методом п'єзоопору 84
- Визначення константи деформаційного потенціалу Ξ_d в n-Si 162
- Визначення константи деформаційного потенціалу Ξ_d в n-Si методом п'єзоопору = Determining the Deformation Potential Constant Ξ_d in n-Si by the Method of Piezoresistance 90
- Визначення константи зсуву деформаційного потенціалу в кремнії і германії при наявності радіаційних дефектів 155
- Визначення константи зсуву деформаційного потенціалу в монокристалах n-Si при наявності радіаційних дефектів 152
- Визначення потенціалів іонізації і збудження газів методом електронної спектроскопії 223
- Визначення швидкості зміщення глибоких енергетичних рівнів у монокристалах кремнію при одновісній пружній деформації 77
- Використання методу вимірювання поздовжнього п'єзоопору для визначення модуля пружності в монокристалах n-Ge 189
- Відпал дефектів в нейтронно опроміненних монокристалах Cd Sb 62
- Властивості багатодолинних напівпровідників зі структурними дефектами технологічного і радіаційного походження 3,4
- Влияние одноосной упругой деформации на подвижность носителей тока в монокристаллах n-Si при наличии глубоких энергетических уровней 156

Влияние одноосной упругой деформации на положение глубоких энергетических уровней в кристаллах n-Si(Ge) 157

Влияние радиационных дефектов на некоторые электрические и оптические свойства монокристаллов антимонида кадмия = Effect of Radiation-induced Defects on the Electrical and Optical Properties of Cadmium Antimonide Single Crystals 57

Влияние радиационных дефектов на пьезосопротивление n-Si 163

Влияние слоистых периодических неоднородностей на пьезосопротивление γ -облученных монокристаллов n-Si и n-Ge 67

Влияние γ -облучения на пьезосопротивление и подвижность носителей заряда в n-Ge при наличии слоистых периодических неоднородностей 146

Вольтамперні характеристики антимоніду кадмію, опромінених швидкими нейтронами 126

Вольт-амперні характеристики поверхнево-бар'єрних структур In/CuInS₂-ZnIn₂S₄ 118

Вплив глибоких енергетичних рівнів на електрофізичні властивості монокристалів n-Si 78

Вплив глибоких енергетичних рівнів на п'єзоопір n-Si 164

Вплив глибоких енергетичних рівнів на тензоефекти у кристалах n-Ge<Au> 81

Вплив дози гамма-опромінення на структурні порушення у монокристалах антимоніду кадмію 190

Вплив домішок Te та In на дефектність монокристалів антимоніду кадмію 176

Вплив донорної домішки SbI₃ на деякі електрофізичні параметри твердих розчинів n-типу (Bi₂Te₃)_{0,9}(Sb₂Te₃)_{0,05}(Sb₂Se₃)_{0,05}+0,5 ваг. % Te 70

Вплив ізовалентної домішки германію на неоднорідність питомого опору в кристалах кремнію 182

Вплив концентрації домішок на зміну положення глибокого рівня $E_C - 0,2$ eV при одновісно пружній деформації в n-Ge<Au> 85

Вплив концентрації домішок на п'єзоопір n-Ge 165

Вплив легуючої домішки телуру на ефект перемикування в кристалах CdSb 140

Вплив наукових досліджень на розвиток відновлювальної енергетики 119

Вплив наявності шарових неоднорідностей на надійність визначення константи деформаційного потенціалу зсуву в γ -опроміненому n-Si 224

Вплив неоднорідностей в розподілі легуючої домішки Te на фізичні властивості монокристалів CdSb 82

Вплив одновісної деформації на заповнення рівня, пов'язаного з A-центром, у кристалах n-Si = Influence of Uniaxial Deformation on the Filling of the Level Associated with A-Center in n-Si Crystals 91

Вплив одновісної пружиної деформації на положення глибоких енергетичних рівнів у монокристалах n-Si(Ge) 83

Вплив одновісної пружної деформації на положення глибоких енергетичних рівнів у кристалах n-Ge<Au> 158

Вплив одновісної пружної деформації на положення глибоких енергетичних рівнів у монокристалах n-Ge<Au> 92

- Вплив одновісної пружної деформації на положення та ступінь заповнення глибокого енергетичного рівня $E_C - 0,17$ eВ в n-Si 166
- Вплив одновісної пружної деформації на положення та ступінь заповнення глибокого рівня $E_C - 0,2$ eВ у монокристалах n-Ge<Au> 93
- Вплив опромінення на фізичні властивості монокристалів антимоніду кадмію 171
- Вплив освітлення на явища переносу в монокристалах антимоніду кадмію 159
- Вплив поверхні на електричні властивості монокристалів CdSb опромінених нейронами 133
- Вплив поверхні на провідність напівпровідника 208
- Вплив пружної деформації на fotocутливість γ -опроміненого n-Ge 135
- Вплив радіаційних дефектів на деякі електричні і оптичні властивості монокристалів антимоніду кадмію 55
- Вплив радіаційних дефектів на електричні властивості CdSb – монокристалів 127
- Вплив радіаційних дефектів на провідність n-Ge при одновісній пружній деформації 63
- Вплив радіаційних порушень на електричні властивості в сурм'янистому кадмію 191
- Вплив структурних дефектів радіаційного походження на фотоелектричні властивості антимоніду і сульфїду кадмію 1,2
- Вплив температури на люмінесцентні властивості стекол системи $Ag_{0.05}Ga_{0.05}Ge_{0.95}S_2-Er_2S_3$ 183
- Вплив температури на оптичні властивості стекол $Ag_{0.05}Ga_{0.05}Ge_{0.95}S_2$, легованих ербієм = Temperature Influence on the Optical Properties of Erbium-Doped $Ag_{0.05}Ga_{0.05}Ge_{0.95}S_2$ Glasses 109
- Вплив технологічних та радіаційних дефектів на тензоефекти в кремнії 149
- Вплив шарів росту на ВАХ монокристалів CdSb з домішкою Te 141
- Вплив шарів росту на електричні ефекти в монокристалах антимоніду кадмію, легованих теллуром 71
- Вплив γ - і нейтронної радіації на оптичні властивості монокристалів CdSb 128
- Вплив γ -опромінення на електричні властивості CdSb 225
- Вплив γ -радіації на оптичні властивості твердих розчинів $Ag_xGa_xGe_{1-x}Se_2$ ($0,12 \leq x \leq 0,4$) 129
- Гетеропереходи в електронній техніці 209
- Дослідження впливу інтенсивності освітлення на кінетичні ефекти в монокристалах антимоніду кадмію 144
- Дослідження глибоких енергетичних рівнів у монокристалах антимоніду кадмію, легованих теллуром, до і після γ -опромінення 76
- Дослідження ефекту п'єзоопору в багатодолинних напівпровідниках з глибокими енергетичними рівнями 150
- Дослідження кінетичних ефектів в монокристалах антимоніду кадмію при різних фізико-активних впливах 79

Дослідження неоднорідностей в монокристалах антимоніду кадмію 96
Дослідження неоднорідностей в монокристалах антимоніду кадмію 177
Дослідження температурної залежності електропровідності монокристалів
 $\text{AgGaGe}_3\text{Se}_8$ 198
Дослідження фізичних властивостей мінералу галіт 210

Електрика 10

Електрика і магнетизм 30

Електричні властивості твердих розчинів PbSe-AgSbSe_2 192

Електричні і оптичні властивості монокристалів $\text{Ag}_x\text{Ga}_x\text{Ge}_{1-x}\text{Se}_2$ ($0,12 < x < 0,4$)
130

Електричні машини 43

Електричні та фотоелектричні властивості кристалів $\text{Tl}_{1-x}\text{Ga}_{1-x}\text{Sn}_x\text{Se}_2$ ($x=0,05:$
 $0,1$) 112

Електроніка 44,45

Електронна гармата трансмісійного електронного мікроскопа 199

Електротехніка. У 2 ч. Ч. 1: Кола постійного струму. Лінійні кола змінного
струму. Трифазні кола електричного струму 46

Електротехніка. У 2 ч. Ч. 2: Трансформатори. Комплексний метод розрахунку
електричних кіл синусоїдного струму 47

Енергетичні стани технологічних термодонорів у нейтронно-легованому
кремнію 184

Енергія активації технологічних термодонорів у нейтронно-легованому кремнії
= Activation Energies of Technological Termodonors in Neutron Doped Silicon 106

Ефект перемикування в кристалах CdSb , легованих Te 72

Загальна фізика. Механіка, молекулярна фізика і термодинаміка 13

Залежність типу провідності сполук $\text{A}^{\text{IV}}\text{B}^{\text{III}}\text{C}_2^{\text{VI}}$ від катіонного заміщення 211

Зміна провідності у кристалах антимоніду кадмію після гамма-опромінення 217

Інформаційний пошук і робота з бібліотечними ресурсами 48

Іоноселективні електроди з плівковою мембраною на основі
тетрайодобісмутату та тетрайодостибіату для визначення N , N' , N'' -
трифенілгуанідинію 99

Кінетичні ефекти в монокристалах антимоніду кадмію в полях ефективного
зовнішнього впливу 167

Кінетичні ефекти в монокристалах антимоніду кадмію у полях ефективного
зовнішнього впливу 185

Константи деформаційного потенціалу Ξ_u and Ξ_d у n-Si, визначені методом
тензорезистивного ефекту = Deformation Potential Constants Ξ_u and Ξ_d in n-Si
Determined with the Use of the Tensoreistance Effect 97

Люмінесценція неопроміненого та γ -опроміненого монокристалу
 $(\text{Ga}_{69,5}\text{La}_{29,5}\text{Er})_2\text{S}_{300}$ 113

Магістерський семінар 31
 Методи дослідження поздовжнього і поперечного п'єзоопору в кристалах кремнію 196
 Методики та техніки вимірювання іонізації та їх проблематика 115
 Механізм фотолюмінесценції монокристалу $(\text{Ga}_{54.59}\text{In}_{44.66}\text{Er}_{0.75})_2\text{S}_{300}$ 116
 Механізми тензоефектів у нейтронно-легованому γ -опромінену n-Si(P) при сильних одновісних тисках 107
 Механіка 8
 Міждолинне розсіювання електронів у n-Si в області температур 300-450 K 172
 Монокристали $\text{Cd}_{0.96}\text{Zn}_{0.04}\text{Te}$ як матеріал для створення фотоелектроперетворювачів 212
 Морфометрія та механічні властивості плівок карбону, отриманих магнетронним депонуванням в атмосфері аргону 108

 Напівпровідники в світлодіодних приладах 213
 Наука та розвиток сонячної енергетики 226
 Наукові дослідження та розвиток світової відновлювальної енергетики 227
 Науково-технічний прогрес розвитку відновлюваної енергетики в Україні 120

 Операційна система Windows 98 та менеджер файлів Windows Commander 5
 Операційна система Windows 2000 та менеджер файлів Total Commander 7,9
 Определение сдвиговой константы деформационного потенциала в германии и кремнии при наличии радиационных дефектов 160
 Оптика 12
 Оптические и фотоэлектрические свойства монокристаллов $\text{Ag}_x\text{Ga}_x\text{Ge}_{1-x}\text{Se}_2$ ($x=0,12-0,25$) 231
 Оптичні властивості сполук Tl_3PbJ_5 , Tl_3PbBr_5 , Tl_3PbCl_5 131
 Оптичні і фотоелектричні властивості монокристалів $\text{Ag}_x\text{Ga}_x\text{Ge}_{1-x}\text{Se}_2$ ($x=0,14$ і $x=0,25$) 125
 Основи метрології: Похибки вимірювань. Обробка результатів вимірювань 20
 Основи метрології. Ч. 1. Фізичні величини та одиниці їх вимірювання. Види, методи та засоби вимірювань 21
 Основи теорії кіл, сигнали та процеси в електроніці 32
 Основні вимоги до структури та оформлення курсових робіт 14
 Особенности междолинного рассеяния носителей тока в n-Si при высоких температурах = Specific Features of Intervalley Scattering of Charge Carriers in n-Si at High Temperatures 86
 Особенности проводимости γ -облученного антимионида кадмия 173
 Особенности пьезосопротивления γ -облученных монокристаллов n-Ge и n-Si при подсветке 178
 Особенности температурных зависимостей уровня Ферми в монокристаллах антимионида кадмия, легированных теллуром, до и после облучения 168
 Особенности фотопроводимости облученных быстрыми электронами с $E=1,2$ МэВ монокристаллов сульфида кадмия, легированных медью 59
 Особливості впливу глибоких радіаційних центрів на провідність π -Ge при одновісній пружній деформації 136

Особливості впливу ізовалентної домішки германію на неоднорідність питомого опору у кристалах кремнію = Features of Effect of an Isovalent Impurity Germanium on a Non-Uniformity of Specific Resistance in Crystals of Silicon 68

Особливості ефекту п'єзоопору в монокристалах антимоніду кадмію до та після γ -опромінення 228

Особливості п'єзоопору германію в області власної провідності 64

Особливості п'єзоопору Ge при наявності глибоких рівнів та в області власної провідності 65

Особливості п'єзоопору γ -опромінених кристалів n-Si у випадку симетричного розміщення осі деформації відносно всіх ізоенергетичних еліпсоїдів = Peculiarities of Piezoresistance of γ -irradiated n-Si Crystals in the Case of Symmetric Position of the Deformation Axis Relative to All Isoenergetic Ellipsoids 87

Особливості п'єзоопору γ -опромінених монокристалів n-Ge та n-Si при освітленні 137

Особливості структурних неоднорідностей в легованих монокристалах антимоніду кадмію 200

Особливості утворення термодонорів у кристалах n-Si<Ge> 138

Оцінка величини зміщення рівнів радіаційних дефектів у γ -опромінених Ge і Si при одновісному стиску 139

Оцінка гомогенності розподілу часток у карбону в полімерах з використанням морфометричної моделі 205

Педагогічна практика у ВНЗ 33

Педагогічна практика у СНЗ 34

Переддипломна практика 35

Передумови розвитку конкурентоспроможних університетів 186

Перспективні матеріали і технології сонячних елементів 121

П'єзоопір n-Ge в області власної провідності 193

Підвищення рухливості носіїв струму в одновісно деформованих кристалах n-Si та n-Si з ізовалентною домішкою германію = The Increasing of Carriers Current Mobility in Uniaxial Deformed Crystals n-Si and n-Si with the Isovalent Impurity of Germanium 88

Підвищення фотопровідності кристалів халькогеніду індиану талію (TlInSe₂) 114

Підготовка вчителів фізики у закладах вищої освіти відповідно до європейської практики 214

Подвижность носителей заряда в γ -облученных монокристаллах антимонида кадмия, легированных индием 145

Положення рівня Фермі в забороненій зоні антимоніду кадмію при наявності технологічних та радіаційних дефектів 179

Потенціометричне визначення індоліл-3-оцтової кислоти за допомогою ПВХ сенсора з родаміновими основними барвниками 100

Потенціометричний сенсор для визначення фенілантранілової кислоти 101

Практика на виробництві 36

Практикум з математичного аналізу: кратні та криволінійні інтеграли 49
 Природа і відпал центрів швидкої рекомбінації в опромінених електронами з енергією $E=1,2$ МеВ монокристалах сульфїду кадмію 60
 Прямі і непрямі переходи у кристалічних сполуках $\text{TlInX}_2\text{-SnX}_2$ ($X - \text{S, Se}$) 122
 Прямі та непрямі оптичні переходи у кристалічних сполуках $\text{TlInX}_2\text{-D}^{\text{IV}}\text{X}_2$ ($\text{D}^{\text{IV}} - \text{Si, Ge, Sn; X - S, Se}$) 218
 Пьезосопротивление в монокристаллах антимонида кадмия, легированных теллуrom, до и после γ -облучения 151

 Радіотехнічні кола та сигнали 23
 Расчет константы деформационного потенциала Ξ_d в γ -облученном n-Si 174
 Розрахунок величини зміщення глибоких енергетичних рівнів у γ -опромінених монокристалах n-Ge та n-Si 197
 Розрахунок величини зміщення рівнів радіаційних дефектів у γ -опромінених монокристалах n-Si 69
 Розрахунок глибини залягання енергетичних рівнів у монокристалах антимонїду кадмію за даними п'єзоопору 201
 Роль деформації кристалічної ґратки монокристалів сульфїду кадмію в зміні параметрів центрів випромінювальної рекомбінації 89

 Спектр поглинання та фотолюмінесценція монокристалу $(\text{Ga}_{69,75}\text{La}_{29,75}\text{Er}_{0,5})_2\text{S}_{300}$ 215
 Стан наукових досліджень та розвиток відновлюваної енергетики в Україні 229
 Структура спектрів поглинання монокристалів Tl_3Pb_5 ($\Gamma - \text{Cl, Br, J}$) 134
 Структурні елементи напівпровідникових пристроїв 50,54
 Структурні елементи напівпровідникових пристроїв. Ч. 1 : p - n переходи 41
 Структурні елементи напівпровідникових пристроїв. Ч. 2 : Контакти метал-напівпровідник 42

 Температурна залежність електропровідності монокристалів PbSe-AgSbSe_2 202
 Температурная зависимость уровня Ферми в монокристаллах антимонида кадмия при наличии глубокого энергетического уровня $E_C - 0,3$ эВ 147
 Температурні залежності положення рівня Фермі в германії при наявності глибоких енергетичних рівнів 142
 Температурно-електрична нестійкість в монокристалах CdSb , опромінених швидкими нейтронами 56
 Тензорезистивний ефект в монокристалах n-Si<Ge> при наявності радіаційних дефектів 161
 Тензорезистивний ефект в γ -опромінених монокристалах n-Ge при освітленні 98
 Тензорезистивні ефекти у сильно деформованих слабоізоляторних кристалах p-Si(B) при $T=4,2$ К 175
 Тензоэффекты в монокристаллах кремния при наличии радиационных дефектов 153
 Термоелектричні властивості кристалів $\text{AgSbSe}_2\text{-PbSe}$ 123

Технічна механіка 27

Технологические термодоноры в трансмутационно-легированном γ -облученном кремнии 187

Трансмiсійний електронний мiкроскоп 206

Утворення швидких центрiв рекомбiнацiї при електронному опромiненнi спецiально нелегованих i легованих мiддю монокристалiв сульфiду кадмiю 61

Фiзика 6,11,15,16,17,18,19,22,51,52

Фiзика напiвпровiдникiв 53

Фiзика напiвпровiдникiв. У 3 ч. Ч. 1: Кристалiчна структура. Енергетичнi зони та енергетична щiлина 37

Фiзика напiвпровiдникiв. У 3 ч. Ч. 2: Концентрацiя носiїв при тепловiй рiвновазi. Явища перенесення носiїв 24

Фiзика напiвпровiдникiв. У 3 ч. Ч. 3: Фононнi, оптичнi та тепловi властивостi. Гетеропереходи та наноструктури. Основнi рiвняння та приклади 25

Фiзика твердого тiла 26

Фiзичнi властивостi монокристалiв антимонiду кадмiю в полях ефективного зовнiшнього впливу 94

Фотоелектричнi властивостi CdSb-монокристалiв опромiнених γ -квантами ^{60}Co i швидкими реакторними нейтронами 132

Фотоннi пристрої на основi кристалiчних сполуках $\text{TlInX}_2\text{-D}^{\text{IV}}\text{X}_2$ (D^{IV} – Si, Ge, Sn; X – S, Se) 230

Фотоннi пристрої та сенсори. Ч. 1: Свiтлодiоди 28

Фотоннi пристрої та сенсори. Ч. 3 : Фотодетектори 38

Фотоннi пристрої та сенсори. Ч. 4 : Сонячнi елементи 39

Фотопровiднiсть опромiнених електронами монокристалiв сульфiду кадмiю, легованих мiддю 58

Фотопровiднiсть у напiвпровiдниках 40

Энергетическая зависимость коэффициента поглощения света $\text{A}^{\text{I}}\text{B}^{\text{III}}\text{C}_2^{\text{VI}}$ 207

Application of high uniaxial strain methods for semiconductor parameter determination 102

Changing of the Anisotropy Parameter of Mobility in n-Ge Single Crystals with Heterogeneous Distribution of Doping Impurity 105

Composition Dependence of the Direct and Indirect Bandgap for $\text{TlInX}_2\text{-D}^{\text{IV}}\text{X}_2$ (D^{IV} – Si, Ge, Sn; X – S, Se) 219

Determination of Deformation Potential Constant Ξ_d in n-Ge 169

Effect of Uniaxial Pressure on the σ_2 -conductivity of Heavily Doped p-Si(B) 110

Feature of Kinetic Effects in Tellurium-Alloyed Cadmium Antimonide Single Crystals 203

Features of Structural Inhomogeneities in Doped Cadmium Antimonide Crystals 111

Influence of Gamma-Irradiation on Structural Disturbances in Cadmium Antimonide Crystals 220

Influence of Illumination on Anisotropy of Properties in Monocrystals CdSb(Te) 154

Influence of Illumination on Parameter Change of Anisotropy of Mobility in n-Ge Monocrystals with Heterogeneous Distribution of Doping Impurity 73

Investigations Inhomogeneities in Cadmium Antimonide Monocrystals 180

Kinetic Effects in Cadmium Antimonide Crystals Before and After Gamma-Irradiation 124

Low-Temperature Plasticity of Uniaxially Deformed Silicon and Germanium Crystals 221

Monocrystalline Silicon, Whiskers and Nanowires as Advanced Technologies of Uniaxial Strain Sensor 181

Optical Absorption Spectra and Photoluminescence of $\text{Ag}_{1,6}\text{Ga}_{1,6}\text{Ge}_{31,2}\text{S}_{61,6-x}\text{Se}_x$ Glassy Alloys 204

Resonant Tunnelling Through Graphene-Based Double-Barrier Structure 222

Silicon p-MOS and n-MOS Transistors with Uniaxially Strained Channels in Electronic Device Nanotechnology 95

Temperature Dependencies of Fermi Level in Single Crystals of Cadmium Antimonide with Deep Energy Levels 170

The Radiation Stimulated Rise of Mobility of Current Carriers in the Cadmium Antimonide Monocrystals, Alloyed by Indium 143

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК СПИВАВТОРІВ

Богданюк М. С. (Богданюк Н. С.) 6,11,27,55,56,57,89,125,126,127,128,130,132,133,176,231

Божко В. В. 6,11,30,45,55,56,57,58,59,118,123,125,126,127,128,132,133,186,212,231

Божко Н. А. 104,188,192,194,195,202

Бірук О. М. 6,11,120

Булатецький В. В. 129,131,134

Василишина В. І. 191

Войтович В. А. 60,61

Войтович Т. В. 206,208,209

Галян В. В. (Halyan V. V.) 10,12,15,16,17,18,19,22,26,37,39,43,46,47,51,52,58,109,113,116,183,204,215

Головіна Н. А. 33,34

Горгут Г. П. 125,129,130,231

Давидюк Г. Є. (Давидюк Г. Е.) 55,56,57,59,60,61,62,89,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,231

Данилик Я. 209

Данильчук С. П. (Danylchuk S. P.) 122,218,219,230

Данилюк І. В. 116

Дмитрук А. А. 216

Доскоч В. П. 6,11,55,56,57,60,61,62,126,127,128,132,133,135

Євсюк В. М. 228

Єрмаков В. М. (Ермаков В. Н.) (Ermakov V. M.) 95,102,103,106,110,172,175,181,184,187

Журба К. 100

Замуруєва О. В. (Zamurujeva O. V.) 24,25,28,38,39,41,42,48,50,53,54,114,117,119,120,121,122,205,211,218,222,226,227,229,230

Захарчук Д. А. (Zakharchuk D. A.) 24,28,39,41,50,53,64,65,66,67,68,69,73,74,76,77,78,79,80,81,92,93,94,96,98,105,111,124,137,138,139,142,143,144,146,147,149,150,151,152,153,155,158,160,163,166,168,171,173,174,176,177,178,179,180,182,185,190,191,197,200,201,203,217,218,219,220,221,223,224,225,228,229,230

Змій О. Ф. 104,188,194,202

Зубеня Н. 99

Іващенко І. А. (Ivashchenko I. A.) 113,116,204,215

Іллюшко Н. (Иллюшко Н. В.) 104,195

Йонік А. М. 70,71,141

Кажукаускас В. 186
Каліщук Р. М. 134
Качан Ю. 108
Кевшин А. Г. (Kevshyn A. H.) 8,10,12,15,16,17,18,19,20,21,22,40,41,43,44,45,
46,47,50,51,52,109,113,114,116,183,204,215
Кітик І. В. 40
Кльоц О. 198
Кобель Г. П. 10
Коваль Л. В. 94,167,173,178
Коваль Ю. В. (Koval Yu. V.) 25,38,53,68,71,72,75,76,78,79,82,93,94,96,98,105,
111,124,139,140,141,143,144,145,146,147,148,150,151,153,154,159,167,168,170,17
1,173,174,176,177,178,179,180,182,185,190,197,200,201,203,217,220,221,224,225,
228
Козак В. В. 216
Коломоець В. В. (Коломоец В. В.) (Kolomoets V. V.) 95,102,103,106,107,110,
172,175,181,184,187
Колядинський І. 108
Кормош Ж. О. 48,99,100,101
Коровицький А. М. (Коровицкий А. М.) 26,28,37,40,42,66,68,83,88,108,114,
138,157,161,182,205,211
Котюх П. І. 179
Кужель Р. М. 225

Лебедь О. О. 113,116
Луньов С. В. (Лунёв С. В.) (Luniov S. V.) 74,77,80,81,83,84,86,87,88,90,91,92,
93,97,149,150,152,153,155,156,157,158,160,161,162,163,164,166,169,174

Мамчич Я. М. 5,7,9
Мартинюк О. С. 6,11
Матвійчук О. 101
Махновець Г. В. 112
Мельник М. 193
Мирончук Г. Л. 40,112,173,178
Мирончук Д. 198
Мороз В. В. 199,205,206,211
Місюк С. Я. (Мисюк С. Я.) (Misjuk S. Ya.) 83,88,149,157,161,221
Муляр В. П. 11

Назарчук П. Ф. 133,172,175
Наход В. 207
Никируй Л. І. 117,119,120,121,226,227,229
Новосад О. В. (Новосад А. В.) 23,27,30,32,41,42,44,45,50,104,118,121,123,188,
192,194,195,202,212

Олексеюк І. Д. (Олексеюк И. Д.)
104,113,116,125,129,130,131,134,188,194,215,231
Олексеюк С. Т. 131
Остап'юк Т. А. 104,188,194,202

Падалко А. М. 131
Панасюк Л. І. (Панасюк Л. И.) (Panasjuk L. I.) 78,80,81,92,93,95,97,102,103,
106,107,110,111,152,155,158,172,175,181,184,187,200,201,221,224,228
Панкевич З. В. 55
Піскач Л. В. 112
Прокопів В. В. 117

Раренко А. И. 57
Рижук А. О. 202
Росоловська О. 193

Савош В. О. 127
Салій Я. П. 117
Сахарчук В. 108
Сахнюк В. Є. (Sakhnyuk V. E.) 37,42,49,50,53,54,122,218,219,222,226,230
Семенченко Р. М. (Семенченко Р. Н.) (Semenchenko R. N.) 73,74,146,149
Семізоров О. Ф. 70
Скипальский Н. 207
Стасюк Я. В. 213
Столярчук О. К. 198
Супрунович С. В. 48
Сусь Б. Б. 187

Тимошук А. Б. 113
Тимощук В. С. 77
Тищенко П. В. 113,116,215
Торчинюк П. В. 104,188
Третяк А. П. 12,26,116,195,215
Трохимчук П. П. 187
Троцюк В. 58

Урбан О. А. (Urban O. A.) 119,124

Федонюк А. А. 131,134
Федорук В. В. 202
Федосов А. В. (Fedosov A. V.) 63,64,66,67,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,
82,83,84,86,87,88,91,92,135,136,137,139,141,142,144,145,146,147,148,149,151,
152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,167,168,169,170
Федосов В. С. 120,226,227,229

Хвищун М. В. (Khwishchun M. V.) 63,64,65,66,67,68,69,85,136,138,139,143,

149,150,189,193,196,197
Хіврич В. І. (Хиврыч В. И.) 145,184
Хижун О. Ю. 54
Хмарук Г. П. 227

Чосік Д. 108

Шаварова А. П. 231
Шаварова Г. П. 6,8,11,36,60,61,89,125,129,130
Шевчук М. В. (Shevchuk M. V.) 109,183,204,215
Шигорін П. П. 20,21,38,109,123
Шинкарук С. В. 85,165
Шипелик Ю. П. 115,210,223
Шутовський А. М. 49

Яблонський О. 192
Яворський Р. С. 117
Ящинський Л. В. (Ящинский Л. В.) (Yashchynskiy L. V.) (Jashchinskij L. V.)
63,67,68,71,72,75,76,79,82,94,96,98,105,106,111,124,136,137,140,141,144,145,
147,148,151,154,159,166,167,168,170,171,173,174,176,177,178,180,181,182,185,19
0,191,196,197,200,201,203,217,220,221,224,225,228

Bozhko A. 181

Dmytruk O. V. 222

Gorin A. E. 95
Gromova G. V. 95

Kogutyuk P. P. 95

Nazarchuk P. F. 95,102

Orasgulyev B. 102,181